



วงจรถับขาเกตแยกอิสระแบบใหม่สำหรับมอสเฟตและไอจีบีที  
A NEW ISOLATED GATE DRIVE FOR POWER MOSFET AND IGBT



วัน เดือน ปี..... ๑๐ ๑๐ ๒๕๔๐  
เลขทะเบียน..... ๐๓๖๙๖๖  
เลขเรียกหนังสือ..... T.38059. ๑ 417๑

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ปีการศึกษา 2538 นั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

036966

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2538

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง วงจรขับขาเกตแยกอิสระแบบใหม่สำหรับมอเตอร์และไอจีบีที

ผู้จัดทำ

1. นายเฉลิมชัย

นรเศรษฐกมล

2. นายชัยเจริญ

กฤษสิทธิ์

3. นายวิริยะ

รัตนานนท์



อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.นนทวัฒน์ จุลเดชะ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**วงจรถับขาเกตแยกอิสระแบบใหม่สำหรับมอสเฟตและไอจีบีที**  
**A NEW ISOLATED GATE DRIVE FOR POWER MOSFET AND IGBT**

โดย

นาย เฉลิมชัย นรเศรษฐกมล 35104086

นาย ชัยเจริญ กุณสิทธิ์ 35104102

นาย วิริยะ รัตนานนท์ 35104394

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. นนทวัฒน์ จุลเดชะ

**บทคัดย่อ**

วงจรถับขาเกตของมอสเฟตกำลังและไอจีบีทีส่วนใหญ่จะต้องการการแยกอิสระและทำการควบคุมให้แรงดันที่ขาเกตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการควบคุมจังหวะการทำงานของมอสเฟตกำลังและไอจีบีที วงจรถับขาเกตชนิดใหม่ที่จะกล่าวถึงนี้จะอาศัยหม้อแปลงพัลส์ขนาดเล็กร่วมกับความสามารถในการประพุดิตัวเป็นหน่วยความจำของตัวมอสเฟตกำลังเอง โดยหม้อแปลงพัลส์นี้จะทำงานเป็นตัวส่งผ่านพลังงานหรือสัญญาณสองทิศทาง(สัญญาณเกต/สัญญาณเตือนลัดวงจร)ระหว่างไอซีที่ใช้ควบคุมกับวงจรถับขาเกตแยกกราวด์ การส่งพลังงานหรือสัญญาณจะเป็นแบบบวก/ลบซึ่งมีข้อดีคือ สามารถปรับช่วงคิวตี้ไซเคิลได้กว้าง ใช้งานกับความถี่ตั้งแต่ 1 กิโลเฮิร์ตจนถึงหลายร้อยกิโลเฮิร์ต นอกจากนั้นหม้อแปลงพัลส์ยังเป็นตัวแยกกราวด์ของระบบและสามารถใช้งานที่แรงดันสูงๆได้ และเนื่องจากหม้อแปลงพัลส์ทำการส่งผ่านพลังงาน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟช่วยทางด้านทุติยภูมิ ระบบป้องกันการลัดวงจรที่สร้างขึ้นสามารถป้องกันได้ที่กระแสลัดวงจร 30 แอมป์พร้อมกับสัญญาณเตือนจะถูกส่งผ่านจากทางด้านทุติยภูมิไปยังด้านปฐมภูมิโดยผ่านหม้อแปลงพัลส์ตัวเดียวกัน

**ABSTRACT**

Power MOSFET and IGBT gate drive often face isolation and voltage fluctuation constraints. The new gate drive described hereunder uses a small pulse transformer combined with the memory effect of the Power MOSFET. This transformer is operated as a bi-directional energy/signal link (gate control/alarm signal) between a control IC and the floating gate drive. This signal is both positive and negative which has many advantages, a large duty cycle range which can operate with 1kHz to hundreds of kilohertz frequency, providing isolation, high operating voltage and no floating auxiliary supply is required on secondary side because of using the pulse transformer in order to supply energy. When the short circuit protection is operated at 30A short circuit current, an alarm signal is transmitted from secondary to primary through the same pulse transformer.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ เพราะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นนทวัฒน์ จุลเดชะ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างมากในการดำเนินงาน ตลอดจนอาจารย์ท่านอื่นๆ และเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือจนทำให้ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ/ABSTRACT	I
กิตติกรรมประกาศ	II
สารบัญภาพ	V
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 จุดเด่นของวงจร	1
1.1.1 วงจรขับขาเกตแบบใช้แหล่งจ่ายไฟแยกกราวด์	2
1.1.2 วงจรขับขาเกตแบบใช้หม้อแปลงพัลส์	2
1.1.3 วงจรขับขาเกตแบบชาร์จปั๊มพ์	3
1.1.4 วงจรขับขาเกตแบบ bootstrap	4
1.1.5 วงจรขับขาเกตแบบ carrier drive	4
1.2 หลักการพื้นฐาน	7
1.3 ส่วนประกอบเพิ่มเติม	8
1.4 การทำงาน	8
บทที่ 2 หลักการทำงานของวงจร	12
2.1 วงจรส่วนอินพุต	12
2.1.1 หลักการทำงาน	12
2.1.2 การทำงานของ L298	13
2.1.3 การทำงานของ คู่อัต โมโนสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ เบอร์ MC14528B	15
2.2 วงจรส่วนเอาต์พุต	16
2.2.1 การทำให้อุปกรณ์กำลัง นำกระแส	17
2.2.2 การทำให้อุปกรณ์กำลัง หยุดนำกระแส	18
2.2.3 ระบบป้องกันการลัดวงจร	19
2.2.4 ระบบป้องกันการไม่นำกระแสของอุปกรณ์กำลังเนื่องจาก กระแสไดโอดรีคอฟเวอร์รี	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ 2.2.5 วงจรเตือนการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านกา  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

3.1	หน้าที่และการทำงานของหม้อแปลงพัลส์ในวงจร	23
3.2	การออกแบบหม้อแปลงพัลส์	23
3.3	คุณลักษณะของพัลส์ที่ได้จากหม้อแปลงพัลส์	24
3.4	การคำนวณหาพารามิเตอร์ของหม้อแปลงพัลส์	27
บทที่ 4	หม้อแปลงกระแส	30
4.1	หน้าที่ของหม้อแปลงกระแสในวงจร	30
4.2	การออกแบบหม้อแปลงกระแส	30
4.2.1	ขนาดของแกนหม้อแปลงและกระแสแมกนีไทซ์	30
4.2.2	ขั้นตอนในการออกแบบหม้อแปลงกระแส	31
บทที่ 5	ผลการทดลอง	35
บทที่ 6	สรุปและวิจารณ์	38
	เอกสารอ้างอิง	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่1.1 แสดงมอสเฟตกำลังด้านแรงดันสูง	1
รูปที่1.2 วงจรขับเคลื่อนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟแยกกราวด์	2
รูปที่1.3 วงจรขับเคลื่อนแบบใช้หม้อแปลงพัลส์	3
รูปที่1.4 วงจรขับเคลื่อนแบบซาร์จปั๊ม	3
รูปที่1.5 วงจรขับเคลื่อนแบบ bootstrap	4
รูปที่1.6 วงจรขับเคลื่อนแบบ carrier drive	5
รูปที่1.7 แสดงบล็อกไดอะแกรมของวงจร	7
รูปที่1.8 แสดงส่วนประกอบของวงจร	8
รูปที่1.9 ลำดับการควบคุมทางด้านปฐมภูมิ	9
รูปที่1.10 แสดงการวิเคราะห์ห้วงจรด้านทุติยภูมิที่ละชั้น	10
รูปที่2.1 วงจรส่วนอินพุต	12
รูปที่2.2 วงจรภายในของ L298	13
รูปที่2.3 กราฟแสดงลักษณะของสัญญาณควบคุมการหยุดและนำกระแสของมอสเฟตกำลัง	14
รูปที่2.4 บล็อกไดอะแกรมของMC14528B	15
รูปที่2.5 ตารางแสดงค่าความจริงของMC14529B	15
รูปที่2.6 วงจรรวมทางด้านเอาต์พุต	16
รูปที่2.7 วงจรแสดงการทำให้อุปกรณ์กำลังนำกระแส	17
รูปที่2.8 วงจรแสดงการทำให้อุปกรณ์กำลังหยุดนำกระแส	18
รูปที่2.9 วงจรแสดงการป้องกันการลัดวงจร	19
รูปที่2.10 แสดงการป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงานขณะอุปกรณ์กำลังนำกระแส	20
นำกระแส	
รูปที่2.11 วงจรเตือนการลัดวงจร	21
รูปที่3.1 วงจรสมมูลของหม้อแปลงพัลส์	23
รูปที่3.2 แสดงการพันขดลวดทางด้านปฐมภูมิ	24
รูปที่3.3 พัลส์ของสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของหม้อแปลงพัลส์	25
รูปที่3.4 วงจรสมมูลอย่างง่ายของหม้อแปลงพัลส์	25

รูปที่3.5	วงจรมูลทวินินของหม้อแปลงพัลส์	26
รูปที่4.1	(ก) หม้อแปลงกระแสและวงจรถุติภูมิ	30
	(ข) รูปกราฟของกระแสด้านปฐมภูมิ	30
	(ค) รูปกราฟของกระแสที่เกิดขึ้นบน $R_p$ แสดงถึงผลของกระแสแมกนีไตซิ่งของหม้อแปลง	30
รูปที่4.2	กราฟแสดงกระแสทุติภูมิของหม้อแปลงพัลส์	33
รูปที่5.1	สัญญาณพัลส์ที่หม้อแปลงพัลส์และสัญญาณที่ขาเกต-ซอร์ส	35
รูปที่5.2	พฤติกรรมการลัดวงจรของมอสเฟตกำลังเบอร์ PM4550 2C HITACHI	36
รูปที่5.3	วงจรที่ใช้งานจริง	37



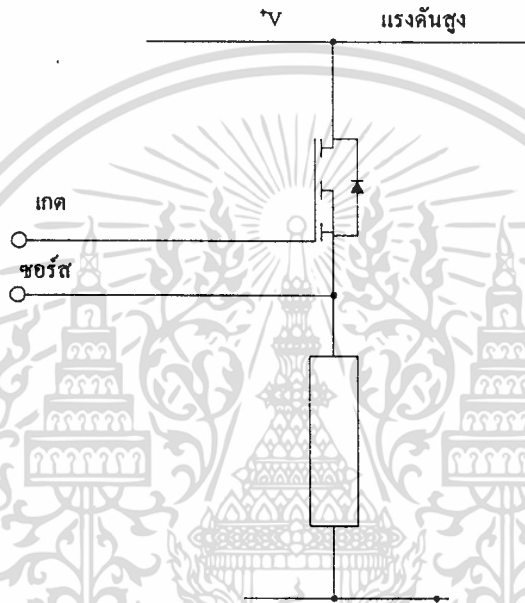
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 จุดเด่นของวงจร

การขับเคลื่อนสำหรับมอเตอร์กำลังหรือไอจีบีทีที่นำมาใช้เป็นสวิตช์ด้านแรงดันสูง (ตรงต่ออยู่กับแหล่งจ่ายแรงดันสูง รูปที่ 1.1) สามารถสรุปลักษณะที่สำคัญได้ดังนี้

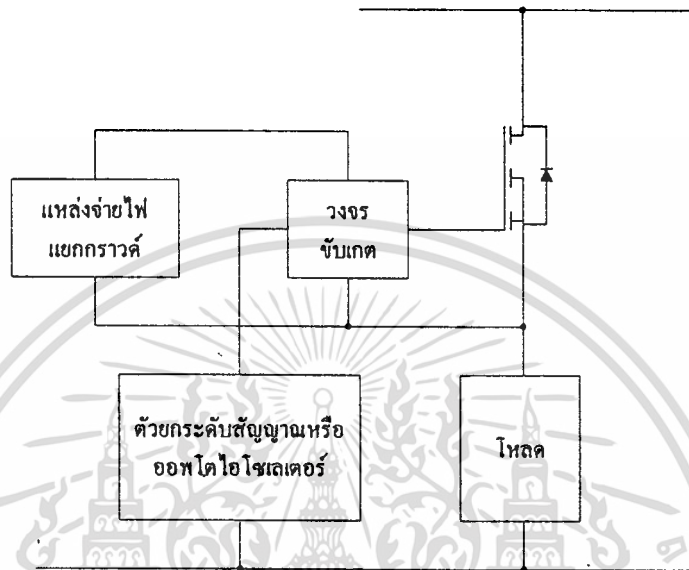


รูปที่ 1.1 แสดงมอเตอร์กำลังด้านแรงดันสูง

1. แรงดันเกตต้องมีค่ามากกว่าแรงดันซอร์ส ประมาณ 10-15 โวลต์เนื่องจากการเอามอเตอร์กำลังหรือไอจีบีทีมาใช้เป็นสวิตช์ด้านแรงดันสูง แรงดันเกตควรจะมีค่าสูงกว่าแรงดันที่ขาซอร์สซึ่งเป็นแรงดันที่มีค่าสูงสุดในระบบ
2. แรงดันเกตต้องควบคุมได้จากวงจรทางตรรก ซึ่งมีจุดอ้างอิง(reference) กับกราวด์ ดังนั้นสัญญาณควบคุมต้องถูกเลื่อนระดับสัญญาณ(level-shifted)ขึ้นไปจากแหล่งจ่ายแรงดันสูงของอุปกรณ์กำลัง
3. กำลังที่เสียไปในวงจรขับเคลื่อนควรมีค่าน้อย ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพรวมของระบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใช้เห็นชอบจะเผยแพร่เอกสารนี้  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.1.1 วงจรขับเคลื่อนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟแยกกราวด์ (Floating gate drive supply )



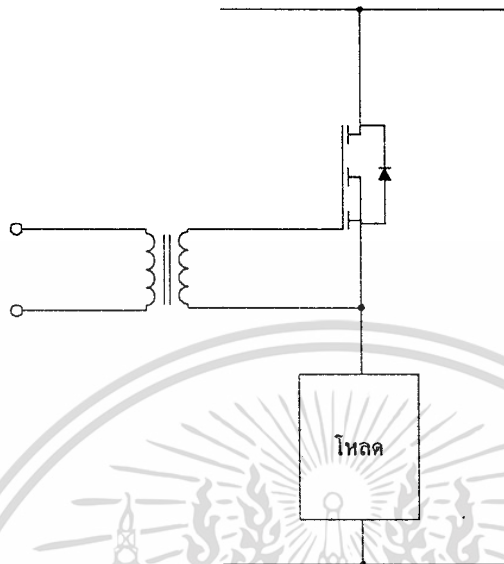
รูปที่ 1.2 วงจรขับเคลื่อนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟแยกกราวด์

สามารถควบคุมเกตได้ตลอดช่วงความถี่ของการใช้งาน การขยับระดับสัญญาณอ้างอิงกับกราวด์สามารถทำได้หลายแบบโดยที่ตัวกระดัดสัญญาณ(level shifter) จะต้องทนแรงดันสูงๆได้ มีการสวิตช์เร็วด้วยเวลาหน่วงที่น้อยที่สุดและกินกำลังน้อย แต่วงจรแบบนี้มีข้อเสียคือราคาแพง เนื่องจากต้องใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นตัวแยกอิสระ(ใช้แหล่งจ่ายไฟหนึ่งตัวสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัว) ดังนั้น ถ้าใช้อุปกรณ์กำลังหลายตัวต้องใช้แหล่งจ่ายไฟหลายชุด นอกจากนั้นออฟไดโอดไฮเลเตอร์ที่ใช้เมื่อเทียบกับวงจรแล้วมีราคาแพง มีค่าแบนด์วิดท์จำกัดและไวต่อสัญญาณรบกวน

### 1.1.2 วงจรขับเคลื่อนแบบใช้หม้อแปลงพัลส์ (Pulse transformer)

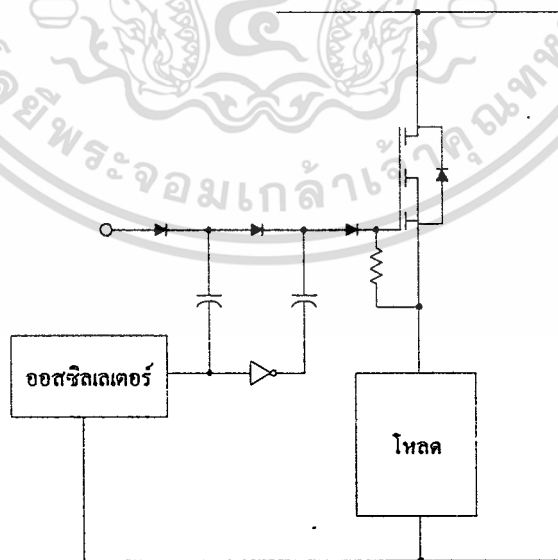
มีข้อดีคือวงจรง่ายและใช้งานได้ดีพอสมควรแต่มีข้อจำกัดหลายประการคือ การทำงานในช่วงควิตซ์ไซเคิลที่กว้างกว่าต้องมีเทคนิคที่ซับซ้อนช่วย เมื่อความถี่ที่ใช้งานลดลงต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่ขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1.3 วงจรจับเกิดแบบใช้หม้อแปลงพลัส

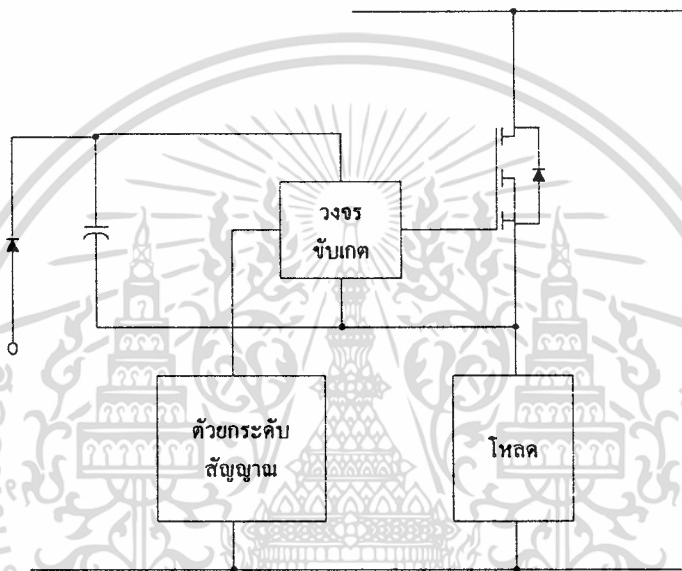
### 1.1.3 วงจรจับเกิดแบบ Charge pump



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการรูปที่ 1.4 วงจรจับเกิดแบบ charge pump อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สามารถนำมาใช้กับงานที่ให้อุปกรณ์กำลังมีเวลานำกระแสยาวนาน ซึ่งจะถูกควบคุมโดยตัวกระตุ้นสัญญาณหรือตัวปัมป์เกต แต่อาจต้องใช้การปัมป์เกตเพื่อคงค่าแรงดันมากกว่าสองสภาวะเนื่องจากวงจรทวิแรงดันที่ใช้มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ

#### 1.1.4 วงจรขับเกตแบบ Bootstrap



รูปที่ 1.5 วงจรขับเกตแบบ bootstrap

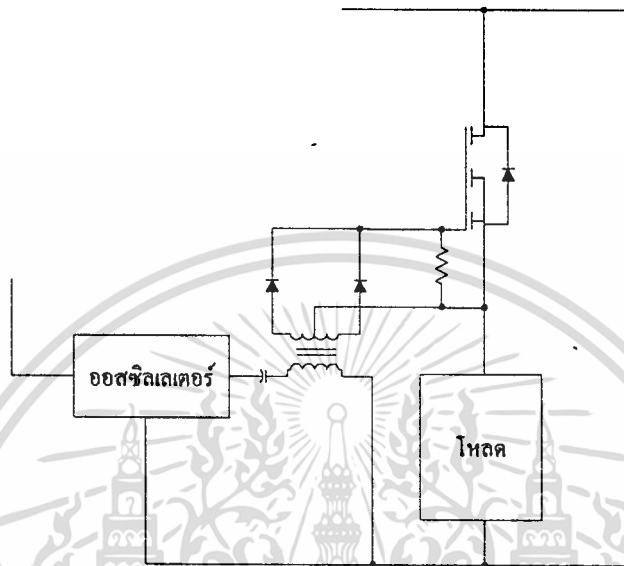
เป็นวงจรง่ายและไม่ซับซ้อนเหมือนกับแบบใช้หม้อแปลงฟลัสต์ ในการใช้งานกับควิตีไซเคลิกกว้างๆสามารถควบคุมเวลาในการออนและควิตีไซเคลิกได้จากกรรพีเฟรชตัวเก็บประจุ bootstrap แต่กำลังที่ใช้ในวงจรจะสูญเสียมากถ้าตัวเก็บประจุถูกชาร์จจากแรงดันสูงและต้องมีตัวกระตุ้นสัญญาณในการใช้งานที่ซับซ้อน

#### 1.1.5 วงจรขับเกตแบบ Carrier drive

สามารถควบคุมเกตด้วยคาบเวลาที่ไม่จำกัดแต่จะถูกจำกัดสมรรถนะในการสวิตชิงสามารถแก้ไขได้โดยเพิ่มวงจรรย่อยเข้าไปอีก

จะเห็นได้ว่าวงจรขับเกตที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังมีข้อเสียอยู่หลายประการ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการทำวงจรขับเกตออกมาเป็น ไอซีขายในท้องตลาดแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมไว้วางใจจากผู้ใช้เพราะการแยกกราวด์ของระบบจะใช้เข็มคอนดักเตอร์เป็นตัวแยกกระหว่างวงจรควบคุมและวง

จรรยาบรรณอุปกรณ์กำลัง เมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลาานานสารเคมีคอนดักเตอร์มีโอกาสเสื่อมได้ทำให้ประสิทธิภาพการแยกอิสระลดลง



รูปที่ 1.6 วงจรขับเคลื่อนแบบ carrier drive

สำหรับวงจรที่ออกแบบมาในปริณญาณิพนธ์นี้ มีข้อได้เปรียบกว่าวงจรที่ใช้ทั่วไปดังนี้

1) ไม่ต้องมีแหล่งจ่ายไฟช่วย(No floating auxiliary supply)

โดยการนำเอาอุปกรณ์กำลังมาทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทั้งหมดในวงจรจะได้รับสัญญาณพัลส์จากหม้อแปลง ดังนั้นวงจรขับจึงไม่ต้องการแหล่งจ่ายไฟช่วย มีเพียงแหล่งจ่ายสำหรับวงจรควบคุมเพียงชุดเดียวเท่านั้น

2) มีช่วงความถี่ในการทำงานกว้าง(High operating frequency range)

วงจรถูกกล่าวสามารถทำงานได้ตั้งแต่ความถี่ต่ำๆ(ประมาณ 1 kHz)จนถึงความถี่หลายร้อยกิโลเฮิร์ต เนื่องจากหม้อแปลงให้กำเนิดพัลส์ที่มีช่วงควิต์ไซเคิลแคบมาก ประมาณ 500 นาโนวินาที

3) มีควิต์ไซเคิลสูง(Large duty cycle)

เช่นเดียวกับข้อ 2 ช่วงของควิต์ไซเคิลของวงจรจะมีค่าสูง ค่าต่ำสุดของช่วงเวลาออนและออฟประมาณ 500 นาโนวินาทีซึ่งสามารถทำให้มี ควิต์ไซเคิลได้จาก 0.01-0.99 ที่ความถี่ 20kHz แต่ไม่มีค่าสูงสุดของช่วงเวลาออนหรือออฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4) สามารถทำให้มีช่วงเวลาในการนอนยาวนานได้ (ทำงานที่ความถี่ต่ำๆ)

เนื่องจากการเทิร์นออฟของอุปกรณ์กำลังใช้หลักการคายประจุของตัวเก็บประจุแฝงที่ขาเกตและซอร์ส จึงสามารถทำให้อุปกรณ์กำลังมีช่วงเวลาในการนอนได้ยาวนานโดยไม่มีการคายประจุของตัวเก็บประจุแฝง

5) พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนค่าทำให้สามารถใช้หม้อแปลงขนาดเล็ก(*Low energy and small transformer requirment*)

พลังงานที่จ่ายโดยหม้อแปลงพัลส์จะประมาณ 4 เท่าของพลังงานที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุแฝงที่ขาเกต(ค่าโดยประมาณต่อ 1 ไซเคิล) ดังนั้นพลังงานโดยรวมเสียไปในวงจรขับจึงมีค่าน้อยมาก นอกจากนั้นแรงดันทางด้านปฐมภูมิที่จ่ายให้กับหม้อแปลงสำหรับช่วงเวลา 500 นาโนวินาทีนั้นประมาณ 5 โวลต์ ทำให้สามารถที่จะรวมเอาหม้อแปลงได้ถึง 3 ตัวลงใน ดีไอแอล แพคเกจ ได้

6) กราวด์ของวงจรขับมีการแยกอิสระเป็นอย่างดีและมีการป้องกันการเกิด  $dV/dt$  ได้อย่างสมบูรณ์ (*Good ground to gate drive isolation and perfect  $dV/dt$  immunity*)

เนื่องจากใช้หม้อแปลงพัลส์เป็นตัวแยกอิสระ ดังนั้นเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่า ระยะครีพเพจ(*creepage distance*) และค่า เคลียแรนซ์(*clearance*) ให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานต่างๆตามความต้องการได้

โดยทั่วไปแล้วหม้อแปลงพัลส์มักจะถูกออกแบบให้มีขนาดที่จะให้ค่าแรงดันปฐมภูมิเท่ากับ 5 โวลต์ เป็นระยะเวลา 500 นาโนวินาที นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะออกแบบหม้อแปลงพัลส์โดยใช้แกนทอรรอยด์ขนาดเล็กที่มีขดลวดพันอยู่เพียงไม่กี่รอบ ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบทางไฟฟ้าระหว่างด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ (*The primary-secondary electrostatic effects*) และยังป้องกันการเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่เกิดอย่างรวดเร็ว( $dV/dt$ ) ได้อย่างสมบูรณ์

7) อิมพีแดนซ์เอาท์พุทของขาเกตต่ำในระหว่างอยู่ในสถานะออฟ (*Low gate impedance during OFF state*)

ช่วงระหว่างการหยุดนำกระแสของอุปกรณ์กำลัง ค่าอิมพีแดนซ์ระหว่างขาเกตและซอร์สจะมีค่าต่ำ ซึ่งจะเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดเทิร์นออนอันเนื่องมาจากการเกิดการแปลงแรงดันแบบทันทีทันใดจากภายนอกได้

8) มีการป้องกันการลัดวงจร(*Short circuit protection*)

วงจรด้านทุติยภูมิจะมีการป้องกันการลัดวงจรโดยอัตโนมัติ แต่ระบบการป้องกันนี้จะไม่ทำงานระหว่างที่มีสัญญาณเทิร์นออนเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันทำงานเนื่องจากกระแสไดโอดรีคอปเวอริ์

### 9) มีสัญญาณเตือน (Alarm signal)

เมื่อมีการลัดวงจรเกิดขึ้นจะมีการคายประจุของตัวเก็บประจุอินพุตแฝงของอุปกรณ์กำลังผ่านหม้อแปลงพัลส์ทำให้หม้อแปลงทำงานในโหมดย้อนกลับ(reverse mode) เพื่อส่งสัญญาณเตือนจากทางด้านทุติยภูมิไปยังด้านปฐมภูมิ

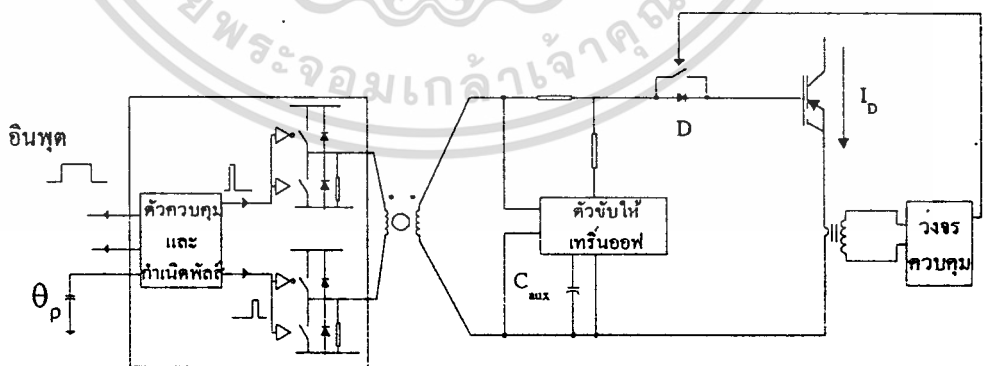
## 1.2 หลักการพื้นฐาน

ประกอบด้วย

- ใช้ตัวเก็บประจุอินพุตแฝงที่เกิดขึ้นระหว่างขาเกตและซอร์สของมอสเฟตกำลังและ ไอจีบีทีเพื่อควบคุมให้เกิดการเทิร์นออน
- ตัวเก็บประจุอินพุตแฝงจะช่วยในการกำจัดสถานะให้เทิร์นออนตลอดเวลา
- นำหม้อแปลงพัลส์ (pulse transformer) มาใช้เพื่อทำให้เกิดการแยกอิสระระหว่างด้านปฐมภูมิกับด้านทุติยภูมิ และเป็นตัวส่งผ่านพลังงานและสัญญาณ(ได้แก่สัญญาณเทิร์นออน,เทิร์นออฟ และสัญญาณเตือน) โดยที่หม้อแปลงพัลส์จะเป็นตัวส่งผ่านพลังงานสองทิศทางดังนี้

ในขณะที่มีสัญญาณพัลส์ที่ขดปฐมภูมิ หม้อแปลงพัลส์จะส่งผ่านพลังงานไปยังด้านปฐมภูมิและทำการกำหนดสถานะขาเกตของมอสเฟตกำลังและ ไอจีบีที (การเทิร์นออนหรือเทิร์นออฟ)

ในขณะที่ไม่มีสัญญาณพัลส์ที่ขดปฐมภูมิ และวงจรอยู่ในสถานะคงตัว(steady state)ถ้ามีการลัดวงจร จะมีสัญญาณเตือนส่งผ่านจากทางด้านทุติยภูมิไปยังด้านปฐมภูมิ

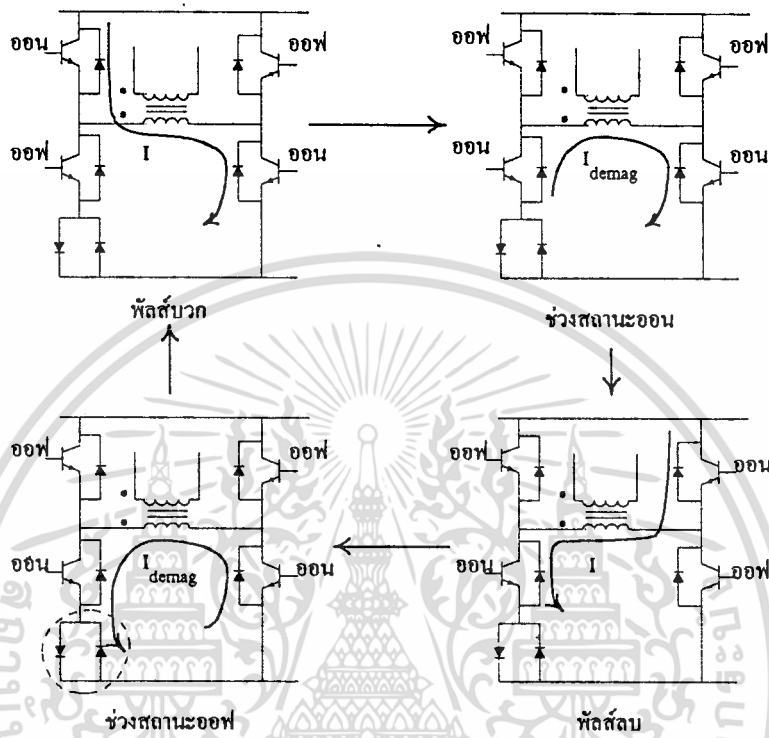


รูปที่ 1.7 แสดงบล็อกโคแอกแกรมของวงจร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ความกว้างพัลส์ : 500 นาโนวินาที



รูปที่ 1.9 ลำดับการควบคุมทางด้านประมุขุมิ

จากรูปที่ 1.9 เป็นการทำงานในสภาวะปกติมีลำดับในการทำงานดังนี้ สัญญาณของกระแสพัลส์ที่เป็นบวกจะเป็นสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์กำลังเทิร์นออนจากนั้นจะเป็นการทำงานเพื่อคายกระแสดีแมกนีไตซ์ (demagnetizing current) สัญญาณพัลส์ที่เป็นลบจะเป็นสัญญาณให้ อุปกรณ์กำลังเทิร์นออฟซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าแรงดันที่ตกคร่อมไดโอดรับรู้สัญญาณ (sense diode) จะเป็นบวกเสมอตลอดในขณะที่มีสัญญาณเทิร์นออฟและขณะคายกระแสดีแมกนีไตซ์ของหม้อแปลงพัลส์

ไดโอดที่ใช้เป็นตัวรับสัญญาณจะอยู่ทางด้านล่างซีกซ้ายสองตัว ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมกระแสดีแมกนีไตซ์เพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณ ในการเกิดการลัดวงจรขึ้นทางด้านทุติยภูมิ

**การทำงานขณะเกิดการลัดวงจร**

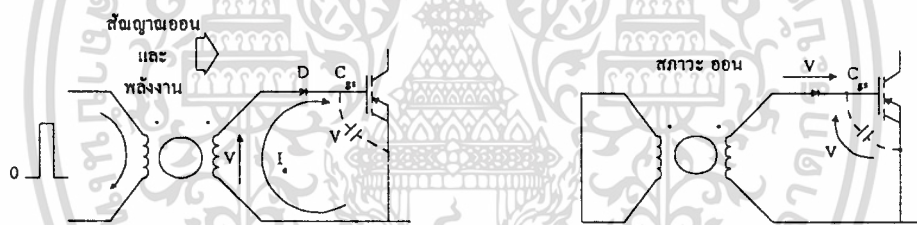
เมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้น จะมีการคายประจุออกมาของตัวเก็บประจุอินพุตแฝง  $C_{in}$  ผ่านด้านทุติยภูมิ ที่จะทำให้เกิดสัญญาณพัลส์ที่เป็นลบของกระแสที่ขั้วทุติยภูมิที่จุดเริ่มต้นของการไหลของกระแสดีแมกนีไตซ์ โดยการกำหนดไซเคิลการทำงานที่วงจรด้านอินพุตของหม้อแปลงพัลส์จะทำ

ให้เกิดกระแสไหลผ่านไดโอดรับสัญญาณ สามารถนำแรงดันที่ตกคร่อมไดโอดนี้ไปใช้เป็นสัญญาณเตือนบอกให้วงจรอินพุตรู้ว่าเกิดการลัดวงจรขึ้น

ข) วงจรด้านทุติยภูมิ(secondary circuit)

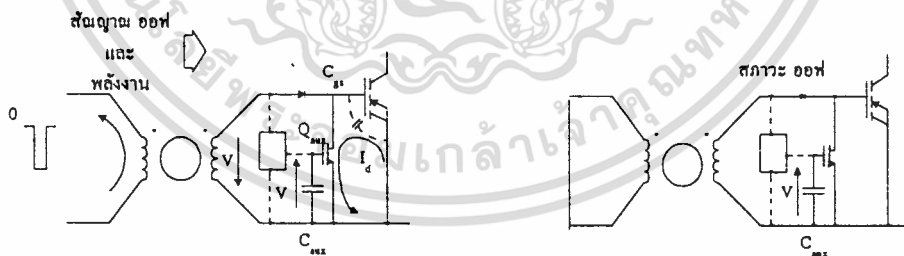
รูปที่ 1.10ก.-1.10ฉ. แสดงถึงการวิเคราะห์ห้วงจรทางด้านทุติยภูมิเป็นขั้นๆ อธิบายได้ดังนี้  
สัญญาณพัลส์เทิร์นออน(Turn-on pulse)

รูปที่1.10ก.แสดงกระแสชาร์จประจุ(charge current:  $I_c$ ) ของตัวเก็บประจุอินพุตแฝงของมอสเฟตกำลัง(หรือ ไอจีบีที)เมื่อมีสัญญาณพัลส์ที่เป็นบวกเข้ามาที่ด้านปฐมภูมิ ดังนั้นจะทำให้มีแรงดันตกคร่อมขาเกตและขาซอร์สมีค่าประมาณบวก15 โวลต์ เนื่องจากตัวเก็บประจุอินพุตแฝงของมอสเฟตกำลัง(หรือ ไอจีบีที)ทำการชาร์จประจุ เมื่อสัญญาณพัลส์ดังกล่าวหายไป จะทำให้แรงดันของหม้อแปลงด้านทุติยภูมิมีค่าประมาณเป็นศูนย์ และเนื่องจากมีไดโอดคั่นนั้นจะป้องกันไม่ให้  $C_{gs}$  คายประจุออกมาได้ จึงทำให้อุปกรณ์กำลังรักษาสถานะการ นำกระแสได้ ดังรูป 1.10ข.



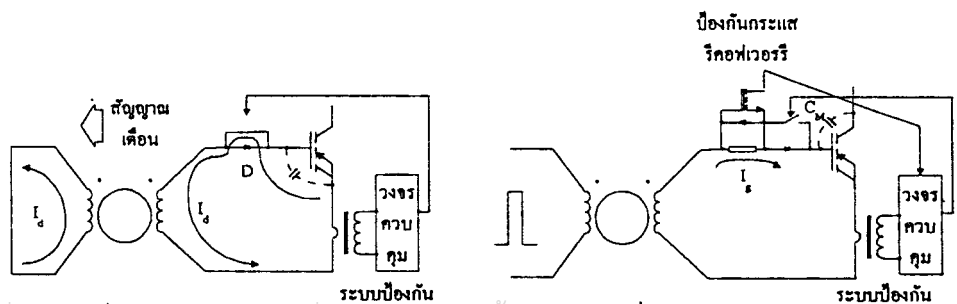
รูปที่ 1.10 ก

รูปที่ 1.10 ข



รูปที่ 1.10 ค

รูปที่ 1.10 ง



ระบบป้องกัน

ระบบป้องกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษารเท่านั้น ไม่อนุญาติให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ การตีความการคำ  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้  
รูปที่1.10 แสดงการวิเคราะห์ห้วงจรด้านทุติยภูมิทีละขั้น

### สัญญาณพัลส์เทิร์นออฟ(Turn-off pulse)

เมื่อมีสัญญาณพัลส์ลบเข้ามาที่ขดปฐมภูมิ(ดูรูปที่1.10ค) จะทำให้ตัวเก็บประจุอินพุตของอุปกรณ์กำลังคายประจุออกมาเนื่องจากตัวเก็บประจุช่วย (auxiliary capacitor:  $C_{aux}$ ) ทำให้  $Q_{aux}$  นำกระแส เมื่อสัญญาณพัลส์หายไป ตัวเก็บประจุ  $C_{aux}$  ไม่สามารถที่จะคายประจุได้ จึงทำให้สภาวะการหยุดนำกระแสยังคงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นค่าอิมพีแดนซ์ระหว่างขาเกตและขาซอร์สของอุปกรณ์กำลังยังมีค่าต่ำด้วย ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดเทิร์นออนขึ้นเองได้ (ดูรูปที่1.10ง.)

### การป้องกันกระแสลัดวงจร(Short circuit protection)

เมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นจะใช้หม้อแปลงกระแส (current transformer) เป็นตัวตรวจจับกระแส โดยเมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นนั้น วงจรจะทำการตัดตัวไดโอด: D ออก ทำให้ตัวเก็บประจุอินพุตสามารถคายประจุออกผ่านไปยังหม้อแปลงพัลส์ได้ ดังนั้นสัญญาณพัลส์ที่เกิดขึ้นทางด้านทุติยภูมิจะถูกส่งผ่านไปยังด้านปฐมภูมิ เป็นสัญญาณเตือนเพื่อบอกว่าเกิดการลัดวงจรขึ้นที่ด้านทุติยภูมิ (ดูจากรูปที่1.10จ.)

### การป้องกันการไม่นำกระแสเนื่องจากเกิดกระแสไดโอดรีคอปเวอร์

ปกติแล้วเมื่อนำเอาอุปกรณ์กำลังไปทำเป็นสวิตช์ ขณะที่สวิตช์เปลี่ยนสถานะจากออฟเป็นออนจะเกิดกระแสไดโอดรีคอปเวอร์ซึ่งเป็นกระแสที่มีค่าใกล้เคียงกับกระแสลัดวงจรที่เกิดขึ้นขณะเกิดการเทิร์นออนเสมอ ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านตัวอุปกรณ์กำลังเพียงพอที่จะทำให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงาน ดังนั้นในช่วงเวลารีคอปเวอร์จึงจำเป็นจะต้องไม่ให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงาน

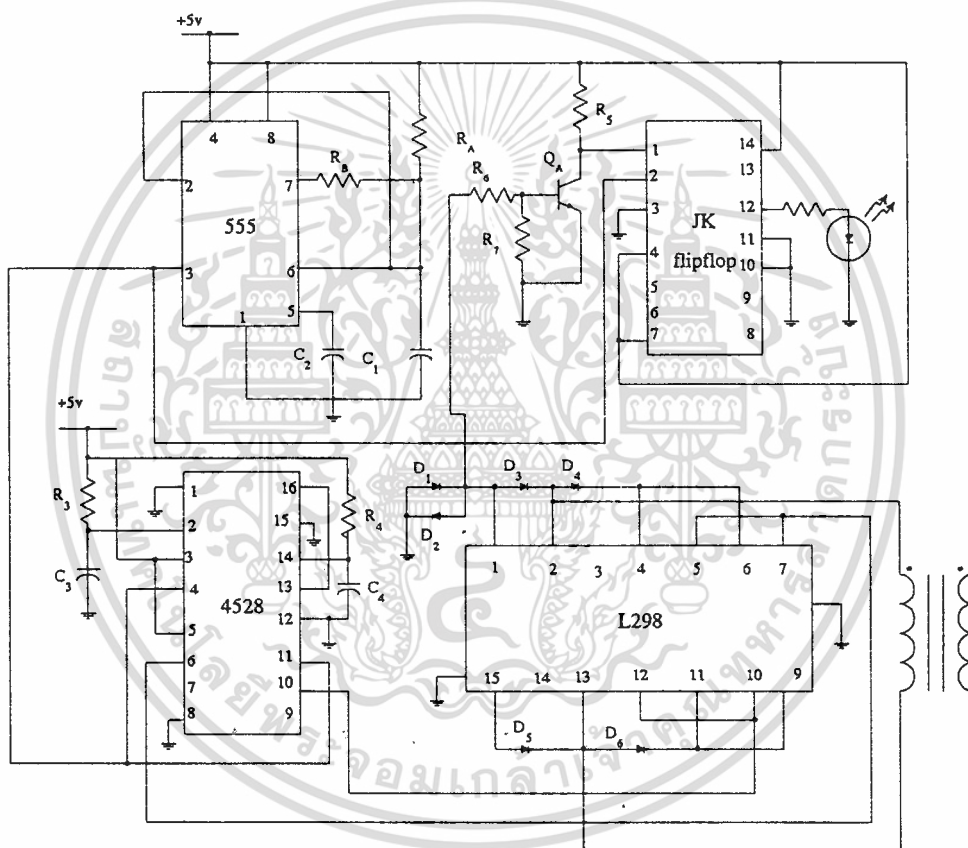
เนื่องจากปรากฏการณ์มิลเลอร์ (Miller effect) จะทำให้กระแส  $i_g$  (จากรูปที่1.10ฉ.) ยังคงอยู่จนกว่าแรงดันตกคร่อมขาคอลเลกเตอร์หรือขาเดรนจะตกลงเป็นศูนย์ ดังนั้นในช่วงที่มีกระแส  $i_g$  จะทำให้เกิดสัญญาณไปควบคุมไม่ให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงานจนกว่ากระแส  $i_g$  หายไป นั่นคือกระแสไดโอดรีคอปเวอร์จะหายไปด้วย หลังจากนั้นระบบป้องกันการลัดวงจรจะทำงานได้ตามปกติเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรขึ้น

## บทที่ 2

### หลักการทํางานของวงจร

#### 2.1 วงจรส่วนอินพุต (Input Circuit)

วงจรส่วนอินพุตประกอบด้วย ไทเมอร์ 555, โมโนสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ เบอร์ 4528, L298 และ ไดโอด



รูปที่ 2.1 วงจรส่วนอินพุต

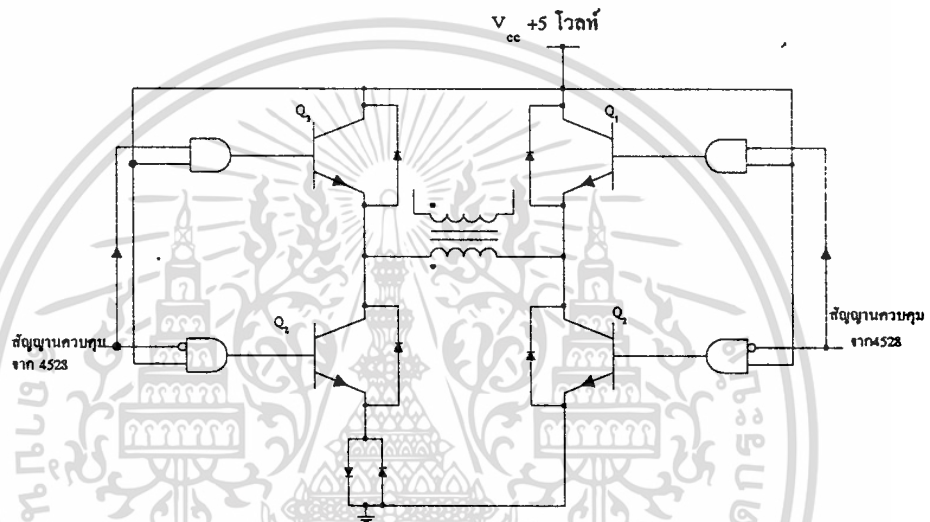
##### 2.1.1 หลักการทํางาน

ไทมเมอร์ 555 จะเป็นตัวกำเนิดสัญญาณพัลส์ออกมาเพื่อนำสัญญาณพัลส์นี้ไปกำหนดลำดับการทํางานของอุปกรณ์กำลัง

4528 มีหน้าที่ในการสร้างสัญญาณพัลส์บวกและลบช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อใช้ในการควบคุมให้ อุปกรณ์กำลังเทอร์นออนและเทอร์นออฟตามลำดับ โดยจะมีสองเอาต์พุต สามารถกำหนดให้เอาท์

พุดหนึ่งทริกสัญญาณพัลส์ที่ขอบขาขึ้นของไทมเมอร์555 เพื่อสร้างสัญญาณพัลส์บวกในช่วงเวลาสั้นๆ(500 นาโนวินาที) ส่วนอีกเอาต์พุดหนึ่งก็ทริกสัญญาณที่ขอบขาลงของสัญญาณจากไทมเมอร์ 555 เพื่อสร้างสัญญาณพัลส์ลบช่วงเวลาสั้นๆ(500 นาโนวินาที) เอาต์พุดจาก 4528 จะนำไปต่อกับ L298 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขับกระแสจ่ายให้หม้อแปลงพัลส์

L298จะรับสัญญาณพัลส์จาก 4528 ทำหน้าที่ขับกระแสจ่ายให้หม้อแปลงพัลส์ มีวงจรภายในซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 วงจรภายในของ L298

สัญญาณพัลส์จาก 4528 จะกำหนดลำดับการทำงานของ L298 ดังนี้  
**ทรานซิสเตอร์ Q1** : รับสัญญาณจากขา 10 ของ โมโนสเตเบิล 4528 ซึ่งเป็นเอาต์พุดที่ให้สัญญาณจากการทริกสัญญาณที่ขอบขาลงของไทมเมอร์ 555

**ทรานซิสเตอร์ Q2** : รับสัญญาณจากการอินเวอร์ตสัญญาณพัลส์ที่ส่งมาจากขา 10 ของ 4528

**ทรานซิสเตอร์ Q3** : รับสัญญาณจากขา 6 ของ โมโนสเตเบิล 4528 ซึ่งเป็นเอาต์พุดที่ให้สัญญาณจากการทริกสัญญาณที่ขอบขาขึ้นของ ไทมเมอร์ 555

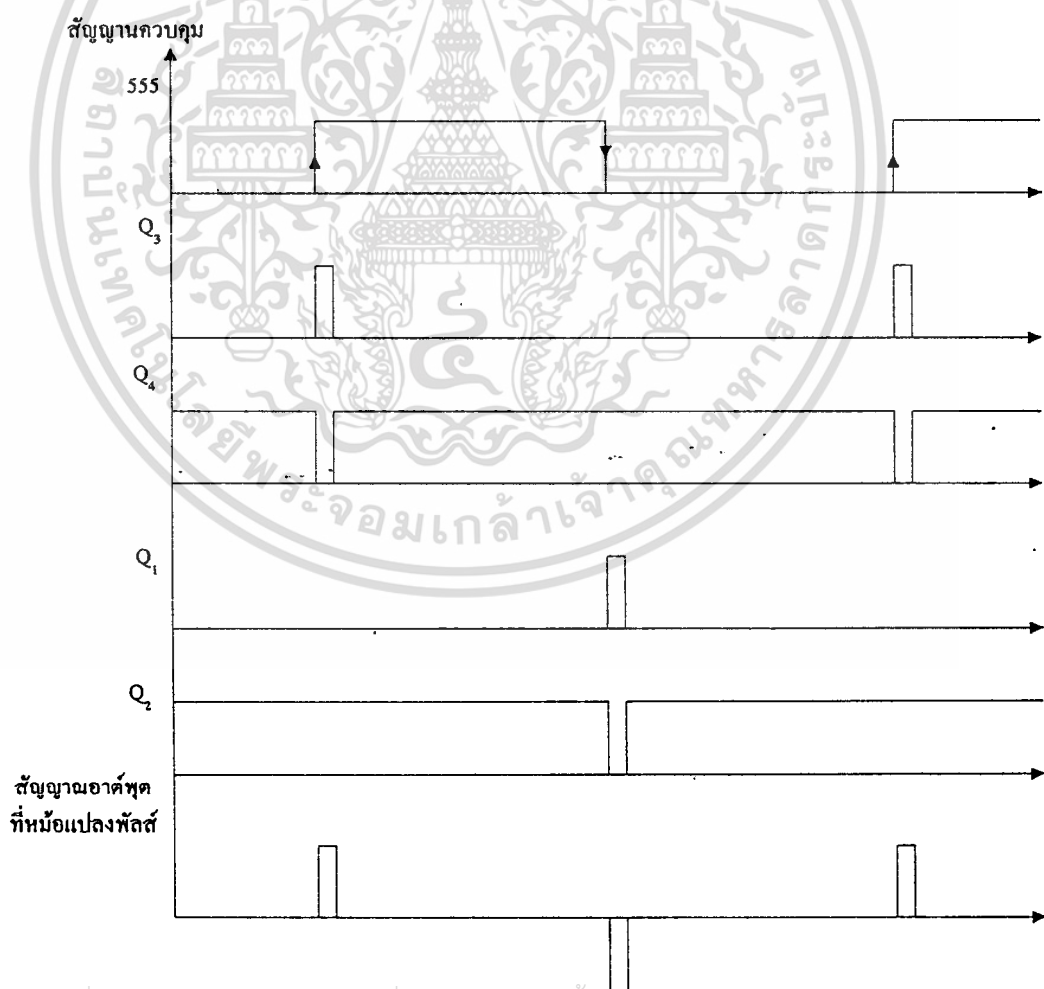
**ทรานซิสเตอร์ Q4** : รับสัญญาณจากการอินเวอร์ตสัญญาณพัลส์ที่ส่งมาจากขา 6 ของ 4528

### 2.1.2 การทำงานของ L298

จากกราฟสัญญาณควบคุมทรานซิสเตอร์ทั้ง 4 ตัวภายใน L298 ที่ได้รับจาก 4528 ในช่วงขอบเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษานานาชาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ขาขึ้นของสัญญาณพัลส์ที่ได้จาก ไทมเมอร์ 555 ทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q3 จะทำงานทำให้กระแสไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไหลผ่านจากทรานซิสเตอร์Q3 ผ่านขดลวดของหม้อแปลงมายังทรานซิสเตอร์Q2 ทำให้ครบรอบการทำงาน ได้สัญญาณพัลส์บวกออกมา หลังจากนั้นทรานซิสเตอร์Q3จะหยุดนำกระแสแต่ทรานซิสเตอร์Q2 ยังคงนำกระแสอยู่ ในช่วงเวลานี้จะมีการคายพลังงานจากขดลวดของหม้อแปลงในรูปของกระแสดีแมกนี ไตซ์ โดยอาศัยไดโอดควนกระแสคายพลังงานผ่านไดโอดของทรานซิสเตอร์Q4 ไปยังทรานซิสเตอร์Q2

ในช่วงขอบขาลงของสัญญาณพัลส์ที่ได้จาก ไทเมอร์ 555 ทรานซิสเตอร์Q4 และ Q1จะทำงานโดยกระแสไหลจากทรานซิสเตอร์Q1 ผ่านขดลวดหม้อแปลงไปยังทรานซิสเตอร์Q4 ทำให้ได้สัญญาณพัลส์ลบออกมา หลังจากนั้นทรานซิสเตอร์Q2 จะหยุดนำกระแสแต่ทรานซิสเตอร์Q1 ยังคงนำกระแสอยู่ จึงมีการคายพลังงานออกมาเช่นเดียวกับการทำงานในช่วงแรก โดย ไดโอดของทรานซิสเตอร์Q2 จะเป็น ไดโอดควนกระแส มีการคายพลังงานในรูปกระแสดีแมกนี ไตซ์ผ่านทรานซิสเตอร์Q4



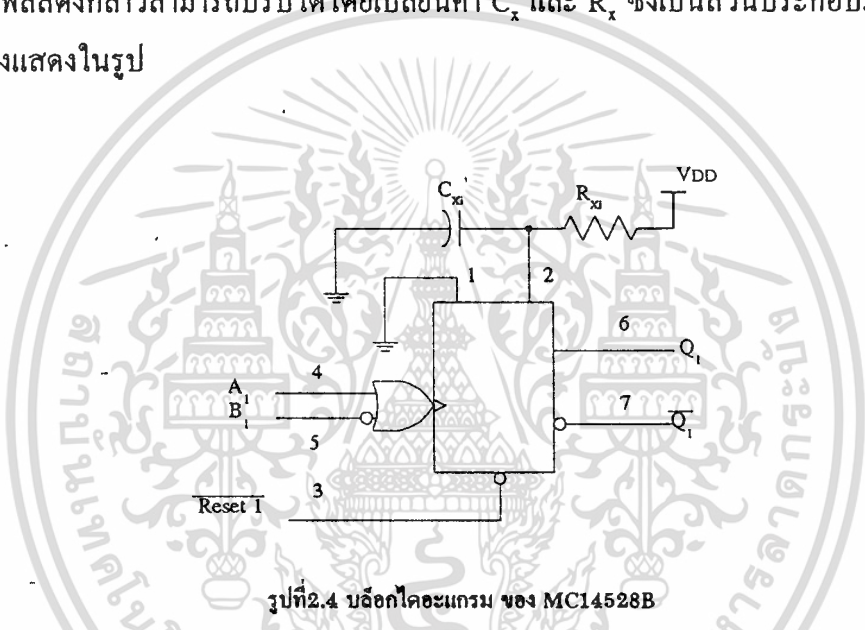
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.3 กราฟแสดงลักษณะของสัญญาณควบคุมการหยุดและนำกระแสของมอเตฟต์กำลัง

การทำงานจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทำให้ได้สัญญาณออกมาตามต้องการ และการกำหนดความถี่ในการทำงาน สามารถกำหนดได้จากความถี่ของไทมเมอร์555

2.1.3 การทำงานของ คูอัล โมโนสเตเบิล มัลติไวเบเรเตอร์ เบอร์ MC14528B

MC14528B เป็นโมโนสเตเบิล มัลติไวเบเรเตอร์ ซึ่งสามารถทริกสัญญาณได้ทั้งที่ขอบขาขึ้นและขอบขาลงของสัญญาณอินพุตและให้สัญญาณเอาต์พุตออกมาเป็นพัลส์ ซึ่งความกว้างของสัญญาณพัลส์ดังกล่าวสามารถปรับได้โดยเปลี่ยนค่า  $C_x$  และ  $R_x$  ซึ่งเป็นส่วนประกอบภายนอกที่ต้องเข้าไป ดังแสดงในรูป



รูปที่ 2.4 บล็อกไออะแกรม ของ MC14528B

การกำหนดให้ MC14528B สามารถทริกสัญญาณที่ขอบขาขึ้นหรือขาลงนั้น จะต้องกำหนดสถานะการทำงานดังรูปที่ 2.5

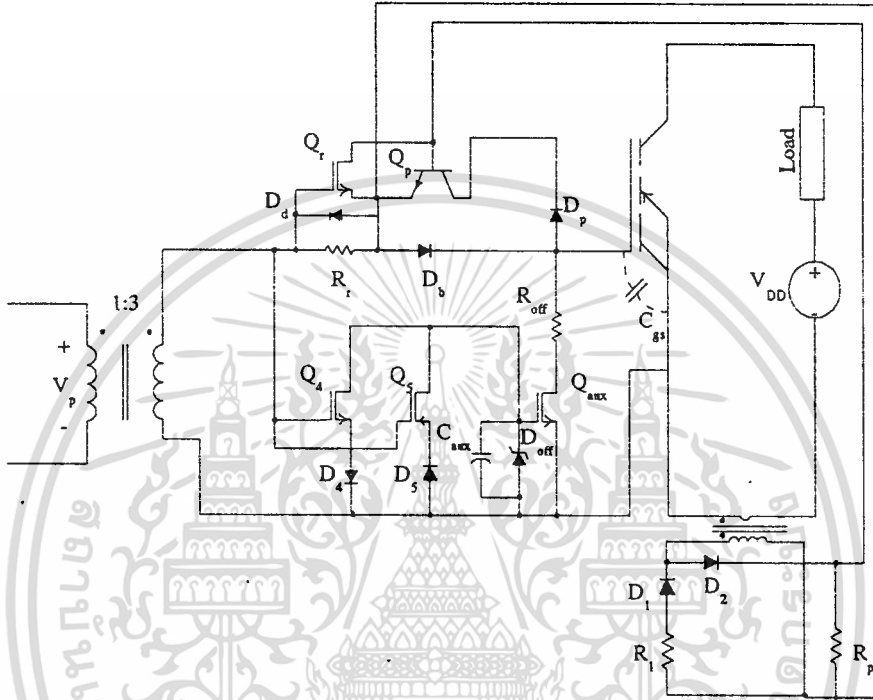
Reset	อินพุต		เอาต์พุต	
	A	B	Q	$\bar{Q}$
H		H		
H	L			

รูปที่ 2.5 ตารางแสดงค่าความจริง ของ MC14528B

รายละเอียดต่างๆของ คูอัล โมโนสเตเบิล มัลติไวเบเรเตอร์ เบอร์ MC14528B นั้นได้แสดงเอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือใช้ซ้ำโดยไม่ขออนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2 วงจรทางส่วนเอาต์พุต



รูปที่ 2.6 วงจรรวมทางด้านเอาต์พุต

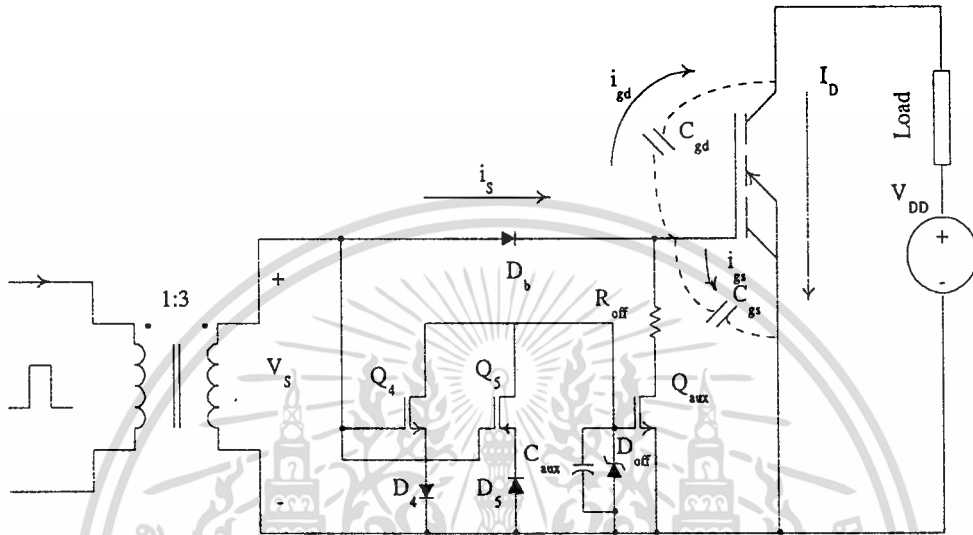
การทำงานของวงจรทางด้านเอาต์พุต ประกอบด้วยการทำงานต่างๆ ดังนี้

1. การทำให้อุปกรณ์กำลัง นำกระแส
2. การทำให้อุปกรณ์กำลัง หยุดนำกระแส
3. มีระบบป้องกันการลัดวงจร
4. มีระบบป้องกันการไม่นำกระแสเนื่องจากกระแสไดโอดรีคอปเวอร์

ซึ่งจะทำการแยกอธิบายแต่ละส่วน ได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.2.1 การทำให้อุปกรณ์กำลัง นำกระแส(เทิร์น-ออน)



รูปที่ 2.7 วงจรแสดงการทำให้อุปกรณ์กำลัง นำกระแส

- อุปกรณ์กำลังจะนำกระแสได้โดยป้อนสัญญาณพัลส์บวกช่วงสั้นๆ ขนาด 500 นาโนวินาที ของอินพุตที่หม้อแปลงพัลส์ โดยอาศัยหลักการของตัวเก็บประจุแฝงที่เกิดขึ้นในตัวอุปกรณ์กำลัง ระหว่างขาเกตและขาซอร์ส

- เมื่อมีพัลส์บวกเข้ามาที่หม้อแปลง จะทำให้หม้อสเฟด  $Q_4$  นำกระแส ทำให้ตัวเก็บประจุ  $C_{aux}$  คายประจุออกมาจนแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ  $C_{aux}$  มีค่าเป็น "ศูนย์" ส่งผลทำให้หม้อสเฟด  $Q_{aux}$  ไม่นำกระแสตลอดช่วงที่มีพัลส์เป็นบวก

พัลส์บวกที่ผ่านเข้ามานี้ จะเข้าไปชาร์จตัวเก็บประจุแฝง  $C_{gs}$  จนมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้ อุปกรณ์กำลัง นำกระแสได้

จะเห็นว่าเมื่อสัญญาณพัลส์บวกหายไป ตัวเก็บประจุแฝง  $C_{gs}$  จะคายประจุไม่ได้ เนื่องจาก มีไดโอด  $D_b$  บล็อกไว้ ทำให้แรงดันคร่อมขาเกตและซอร์สเป็นบวกตลอดเวลา

**การคำนวณหากระแสขาเกตของอุปกรณ์กำลังขณะทำให้เทิร์นออน**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
จากรูปที่ 2.7 ให้  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้  
 $C_{gs}$  คือ ตัวเก็บประจุแฝงระหว่างขาเกตและขาซอร์สของอุปกรณ์กำลัง

$C_{gd}$  คือ ตัวเก็บประจุแฝงระหว่างขาเกตและขาเดรนของอุปกรณ์กำลัง

$V_s$  คือ แรงดันสูงสุดของพัลส์บวกที่หม้อแปลงค้ำทุติยภูมิ

$$I_s = I_{gd} + I_{gs}$$

$$I_s = C_{gd} \frac{d(V_s - V_{ds(on)} - V_{diode(on)})}{dt} + C_{gs} \frac{d(V_s - V_{diode(on)})}{dt}$$

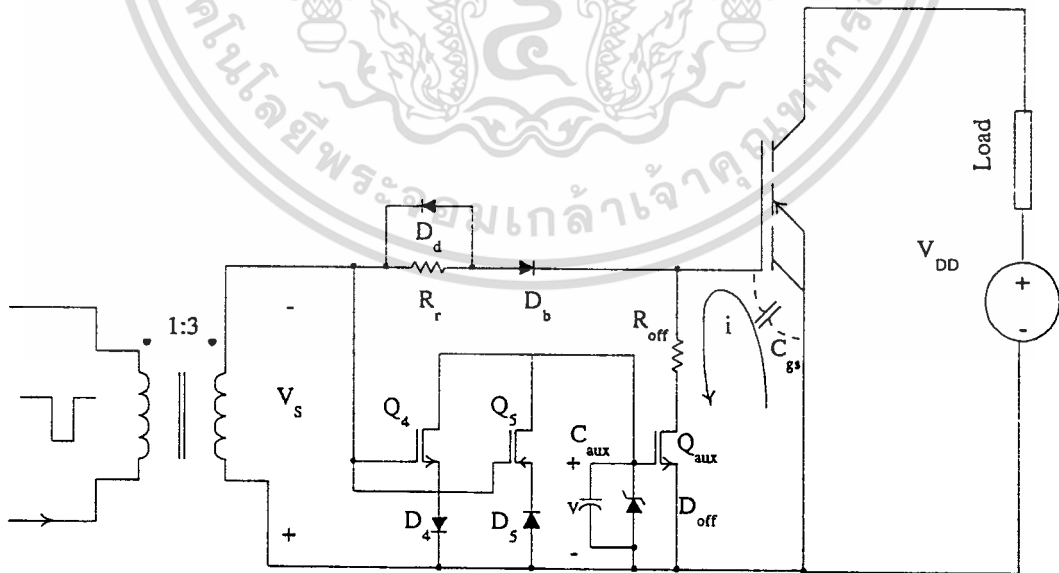
ให้  $V_{ds(on)}$  และ  $V_{diode(on)}$  มีค่าประมาณ 0 โวลต์

$$I_s = (C_{gs} + C_{gd}) \frac{dV_s}{dt}$$

$$= (C_{gs} + C_{gd}) \frac{V_s}{t_r}$$

เมื่อ  $t_r$  คือ เวลาขาขึ้นของแรงดันที่ขาเกตและขาซอร์ส มีค่าประมาณ 500 นาโนวินาที

### 2.2.2 การทำให้อุปกรณ์กำลัง หยุดนำกระแส(เทิร์น-ออฟ)



รูปที่ 2.8 วงจรแสดงการทำให้อุปกรณ์กำลัง หยุดนำกระแส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดโครงการวิจัยนี้  
 การหยุดนำกระแสของอุปกรณ์กำลัง ทำได้โดยการคายประจุของตัวเก็บประจุแฝง  $C_{gs}$  มี  
 ไม่ว่าใครก็ตามที่คัดลอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมายและต้องแจ้งถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้  
 การทำงานดังนี้

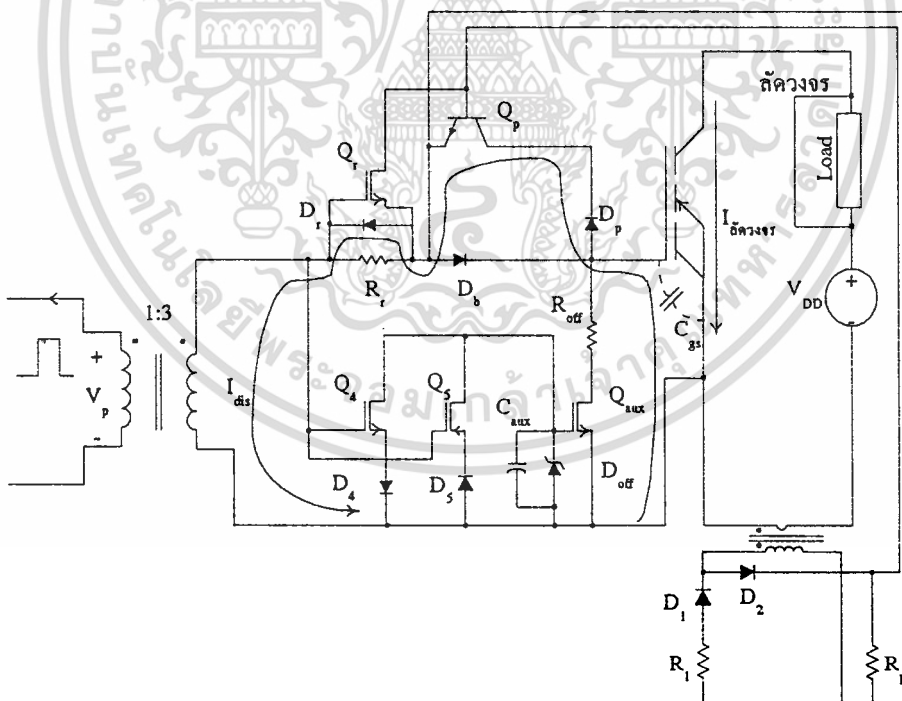


- ส่วนสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์กำลังเทิร์นออฟ คือ  $C_{aux}$  และมอสเฟต  $Q_{aux}$  เมื่อมีพัลส์ลบช่วงสั้นๆ(ขนาด 500 นาโนวินาที) ถูกป้อนเข้ามาที่หม้อแปลงพัลส์ มีผลทำให้มอสเฟต  $Q_5$  ทำงานนำกระแสไปชาร์จตัวเก็บประจุ  $C_{aux}$  จนมีแรงดันคร่อมขาเกตและซอร์สของมอสเฟต  $Q_{aux}$  ทำให้มอสเฟตนำกระแส

- เมื่อมอสเฟต  $Q_{aux}$  นำกระแส จะทำให้ตัวเก็บประจุแฝง  $C_{gs}$  คายประจุผ่าน  $R_{off}$  ทำให้อุปกรณ์กำลังหยุดนำกระแสได้ จะเห็นได้ว่า เมื่อยังไม่มีสัญญาณพัลส์บวกเข้ามาที่หม้อแปลงพัลส์ ตัวเก็บประจุ  $C_{aux}$  จะไม่สามารถคายประจุได้ ทำให้อุปกรณ์กำลังรักษาสถานะการนำกระแสได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีสัญญาณควบคุมจากอินพุตให้อุปกรณ์กำลัง นำกระแส

สำหรับซีเนอร์ไดโอด  $D_{off}$  มีไว้เพื่อป้องกันแรงดันคร่อม  $C_{aux}$  ไม่ให้มีค่าสูงมากเกินไปจนทำให้มอสเฟต  $Q_{aux}$  เสียหายได้

2.2.3 ระบบป้องกันการลัดวงจร



รูปที่ 2.9 วงจรแสดงการป้องกันการลัดวงจร

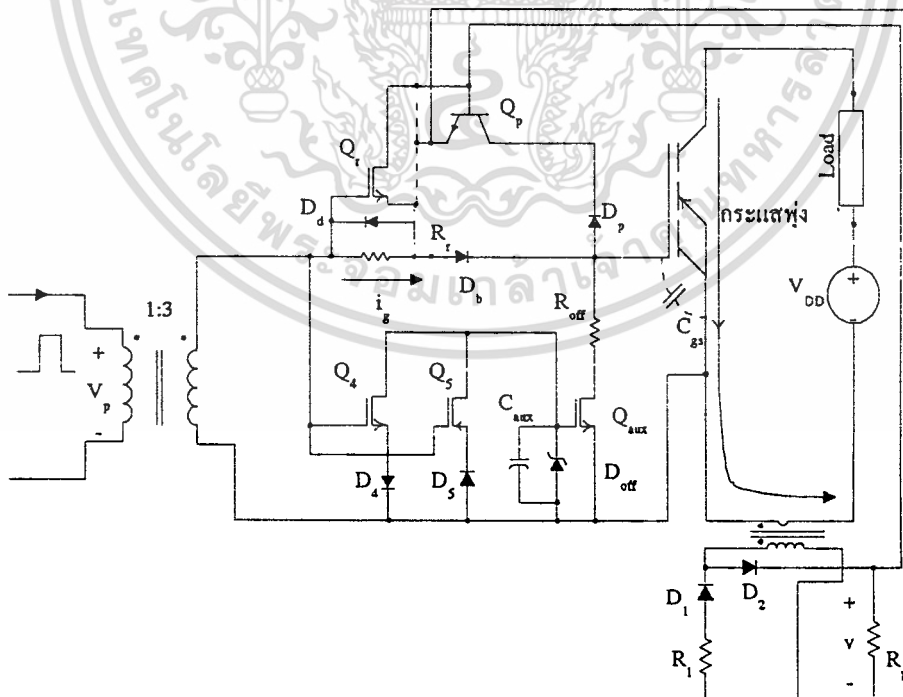
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อมีการลัดวงจรที่โหลด จะทำให้มีกระแสจำนวนมากไหลผ่านอุปกรณ์กำลัง ทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องทำให้อุปกรณ์กำลังหยุดนำกระแสโดยเร็วที่สุด ซึ่งทำได้โดยการคายประจุของตัวเก็บประจุแฝง  $C_{gs}$

- การป้องกัน ทำได้โดยใช้หม้อแปลงกระแสยกยอตรวจจับกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์กำลัง เมื่อมีกระแสลัดวงจรขึ้น หม้อแปลงกระแสจะกำเนิดพัลส์กระแสขึ้นที่ด้านทุติยภูมิเพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงดันคร่อม  $R_p$  จนทำให้ทรานซิสเตอร์  $Q_p$  นำกระแสได้ ดังนั้นตัวเก็บประจุ  $C_{gs}$  สามารถคายประจุผ่าน  $Q_p$  ทำให้อุปกรณ์กำลังหยุดนำกระแสได้ทันก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น

### 2.2.4 ระบบป้องกันการไม่นำกระแสของอุปกรณ์กำลังเนื่องจากกระแสไดโอดรีคอฟเวอรั

เนื่องจากขณะที่อุปกรณ์กำลังเริ่มนำกระแสขึ้น จะเกิดกระแสพุ่งไหลผ่านอุปกรณ์กำลัง มีค่าเพียงพอที่จะทำให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงาน ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์กำลังอาจจะนำกระแสไม่ได้เนื่องจากตัวเก็บประจุแฝง  $C_{gs}$  สามารถคายประจุผ่านทรานซิสเตอร์  $Q_p$  ได้ ดังนั้นจึงต้องป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงานในช่วงที่มีสัญญาณพัลส์บวกควบคุมให้นำกระแส

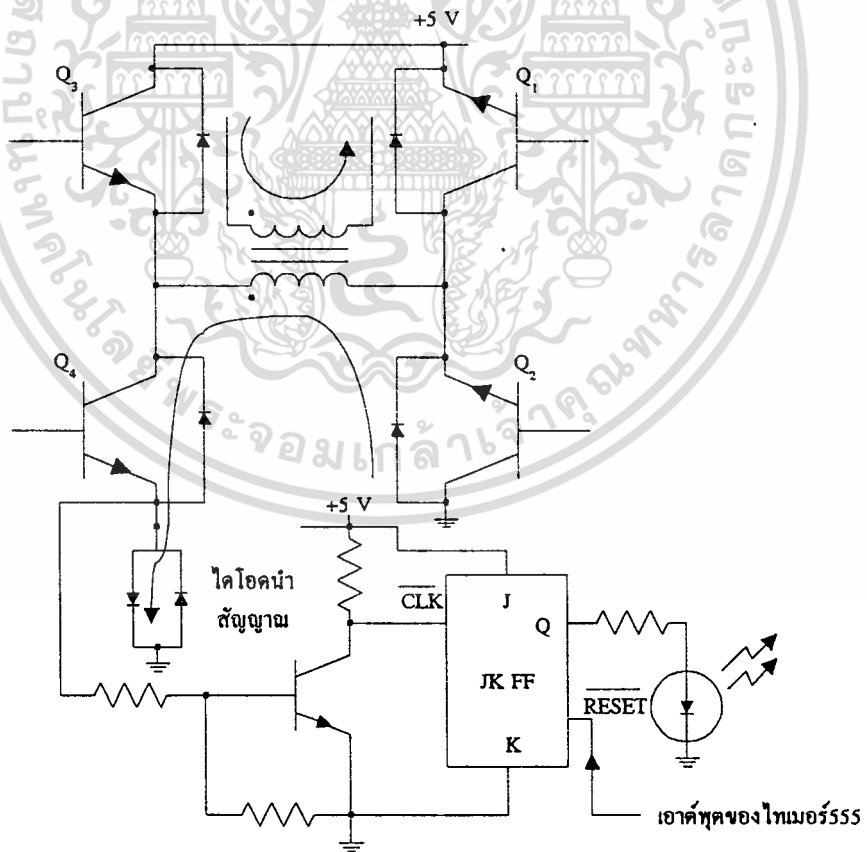


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 รูปที่ 2.10 แสดงการป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงานขณะ  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดูอุปกรณ์กำลังกำลังนำกระแสอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขณะที่ตัวเก็บประจุ  $C_{gs}$  ทำการชาร์จประจุอยู่ จะทำให้มีกระแสไหลผ่าน  $R_f$  จนมีแรงดันตกคร่อมทำให้มอสเฟต  $Q_4$  ทำงานซึ่งส่งผลให้แรงดันคร่อมขาเบสและอีมีเตอร์ของทรานซิสเตอร์  $Q_4$  มีค่าเป็นศูนย์ตลอดเวลาที่  $C_{gs}$  ชาร์จประจุ นั้นแสดงว่าระบบป้องกันการลัดวงจรจะไม่ทำงานในช่วงเวลานี้

2.2.5 วงจรเตือน( Alarm circuit )

วงจรเตือนมีจุดประสงค์เพื่อบอกผู้ใช้งานเมื่อมีการลัดวงจรที่โหลดด้านเอาต์พุตโดยขณะที่เกิดการลัดวงจร จะมีกระแสที่เกิดจากการคายประจุของตัวเก็บประจุ  $C_{gs}$  (ตัวเก็บประจุที่อยู่ในอุปกรณ์กำลัง) ไหลจากวงจรด้านเอาต์พุตผ่านขดลวดของหม้อแปลง ทำให้เกิดสัญญาณพัลส์ของกระแสที่ด้านปฐมภูมิ มีทิศทางแสดงดังรูป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
**รูปที่ 2.11 วงจรเตือนการลัดวงจร**  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### หลักการทํางาน

จากไชเกิดการทำงานของ L298 การลัดวงจรจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่อุปกรณ์กำลังนำกระแส ซึ่งในช่วงนี้ทรานซิสเตอร์ $Q_A$  ใน L298 จะนำกระแสอยู่ ดังนั้นกระแสจากการคายประจุจากตัวเก็บประจุแฝงในด้านปฐมภูมิ จะไหลผ่านวงจรถ้อน ผ่านไดโอดนำสัญญาณ ทำให้ทรานซิสเตอร์  $Q_A$  ทำงาน ส่งสัญญาณให้กับขาคล๊อคของ เจเค-ฟลิปฟลอป ซึ่ง เจเค-ฟลิปฟลอปนี้จะมีเอาต์พุตที่ต่อกับไดโอดเปล่งแสง(LED)อยู่ ดังนั้นถ้าเกิดการลัดวงจรขึ้น จะทำให้ไดโอดเปล่งแสงสว่างขึ้น

จะเห็นได้ว่าในช่วงที่วงจรทำงาน โดยกำเนิดสัญญาณพัลส์ลบ เพื่อให้อุปกรณ์กำลังหยุดนำกระแส(turn off) และมีกระแสคืนแมกนีไตซ์ ซึ่งกระแสนี้จะไหลผ่านไดโอดนำสัญญาณ ทำให้วงจรถ้อนทำงาน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้วงจรถ้อนทำงานในช่วงนี้ จะทำการต่อขา“รีเซ็ต”ของเจเค-ฟลิปฟลอป เข้ากับสัญญาณพัลส์จากเอาต์พุตของไทเมอร์555 จะเห็นได้ว่าช่วงที่เอาต์พุตของไทเมอร์555มีสถานะเป็น“ศูนย์”ทำให้วงจรถ้อนไม่ทำงาน เนื่องจาก เจเค-ฟลิปฟลอปจะถูกรีเซ็ต ในช่วงนี้จะไม่มีการลัดวงจรเกิดขึ้นที่อุปกรณ์กำลัง เพราะอุปกรณ์กำลังจะหยุดนำกระแสเมื่อเอาต์พุตของไทเมอร์555เป็นศูนย์ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้วงจรถ้อนทำงาน

### บทที่ 3

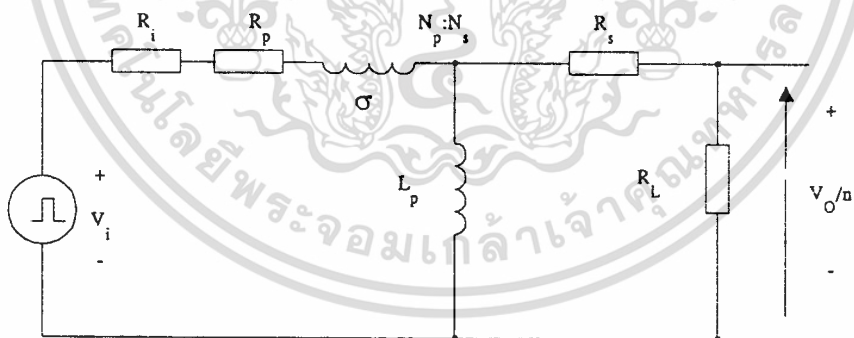
#### การออกแบบหม้อแปลงพัลส์

##### 3.1 หน้าทีและการทำงานของหม้อแปลงพัลส์ในวงจร

- ทำการส่งผ่านสัญญาณควบคุมลำดับการทำงานของอุปกรณ์กำลังทั้งพัลส์บวกและพัลส์ลบจากด้านอินพุตไปยังด้านเอาท์พุต
- ทำการส่งผ่านพัลส์กระแสที่เกิดจากการคายประจุของตัวเก็บประจุแผ่น  $C_{gs}$  ขณะเกิดการลัดวงจรขึ้นที่โหนดจากวงจรด้านเอาท์พุตไปยังด้านอินพุตเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือน
- เป็นตัวแยกทางไฟฟ้าระหว่างวงจรด้านเอาท์พุตออกจากวงจรด้านอินพุตได้อย่างอิสระ ดังนั้น สำหรับการนำเอาอุปกรณ์กำลังหลายๆตัวมาใช้เป็นสวิตช์ สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟอิสระเพียงแค่ชุดเดียว
- กำลังที่หม้อแปลงพัลส์ส่งผ่านนั้นจะมีค่าน้อยมาก จึงสามารถเลือกใช้แกนหม้อแปลงที่มีขนาดเล็กๆได้

##### 3.2 การออกแบบหม้อแปลงพัลส์

หม้อแปลงพัลส์ในทางปฏิบัติสามารถเขียนวงจรสมมูลได้ดังนี้



รูปที่ 3.1 วงจรสมมูลของหม้อแปลงพัลส์

เมื่อ  $R_i$  คือ ความต้านทานอินพุตของหม้อแปลง...(โอห์ม)

$R_p$  คือ ความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิ...(โอห์ม)

$R_s$  คือ ความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิ...(โอห์ม)

$R_L$  คือ ความต้านทานของโหลด

$\sigma$  คือ ค่าความเหนี่ยวนำรั่วไหล(leakage inductance)...(เฮนรี่)

$L_p$  คือ ค่าความเหนี่ยวนำคิแมกนีโตซิง...(เฮนรี่)

$n$  คือ อัตราส่วนรอบของหม้อแปลง...(  $n = N_s/N_p$  )

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค่าความเหนี่ยวนำคิแมกนีไตซิ่ง

สามารถวัดได้จากทางด้านปฐมภูมิขณะเปิดวงจรทางด้านทุติยภูมิ ซึ่งสามารถหาได้จากสมการ

$$L_p = \frac{\mu_o \mu_r A_e N_p^2}{l_e} \quad \text{เฮนรี} \quad \text{.....(3.1)}$$

รูปที่ 3.2 แสดงการพันขดลวดทางด้านปฐมภูมิ

เมื่อ  $\mu_o$  คือ ค่าความซึมซาบแม่เหล็กของอากาศ เท่ากับ  $4\pi \times 10^{-7}$  ... (เฮนรี/เมตร)

$\mu_r$  คือ ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์

$A_e$  คือ พื้นที่หน้าตัดของแกนหม้อแปลง... (ตารางเมตร<sup>2</sup>)

$N_p$  คือ จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ... (รอบ)

$l_e$  คือ ความยาวของทางเดินวงจรแม่เหล็ก... (เมตร)

ให้

$$A_L = \frac{\mu_r \mu_o A_e}{l_e} \quad \text{.....(3.2)}$$

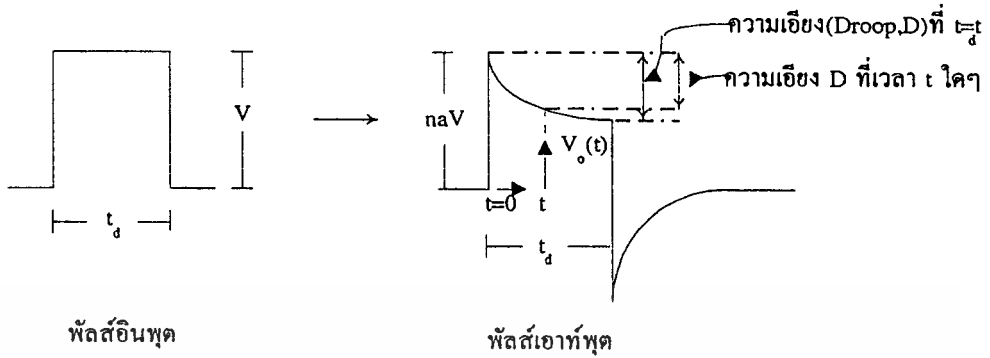
ดังนั้น

$$L_p = N_p^2 A_L \quad \text{.....(3.3)}$$

### 3.3 คุณสมบัติของพัลส์ที่ได้จากหม้อแปลงพัลส์

พัลส์ที่วางจโรนพุตส่งให้หม้อแปลงพัลส์นั้นจะมีลักษณะเป็นพัลส์สี่เหลี่ยม แต่ลักษณะพัลส์ที่ได้ออกมาจากหม้อแปลงจะเป็นดังรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

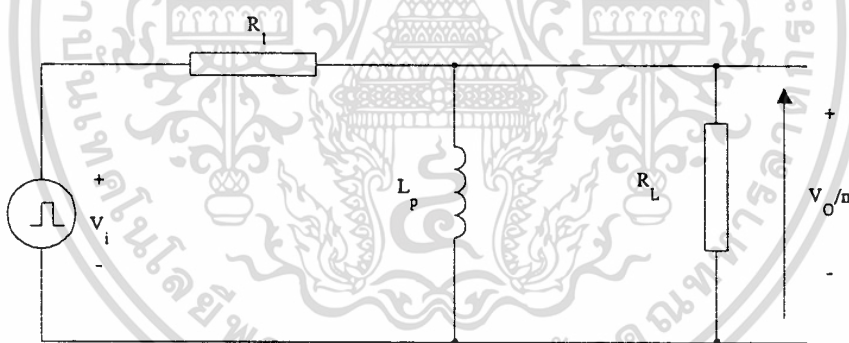


รูปที่ 3.3 พัลส์ของสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของหม้อแปลงพัลส์

สามารถพิจารณาได้ดังนี้

เนื่องจากค่าเหนี่ยวนำรีฟลักซ์  $\sigma$  มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ  $R_i + R_p$  ดังนั้น จากวงจรรูปที่

3.1 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ดังนี้



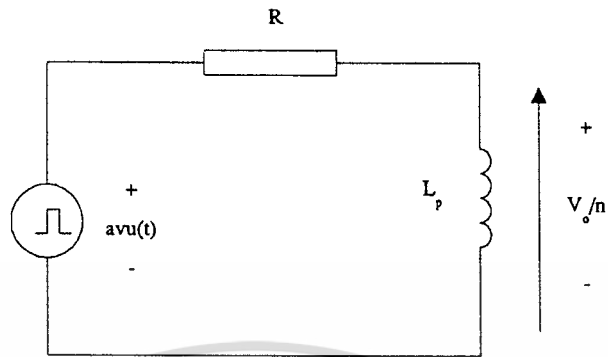
รูปที่ 3.4 วงจรสมมูลอย่างง่ายของหม้อแปลงพัลส์

เมื่อ  $R_1 = R_i + R_p$

$R_2 = R_s + R_L$

โดยใช้ทฤษฎีทวินิน แปลงวงจรรูปที่ 3.4 ให้ อยู่ในรูปที่ 3.5 ได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.5 วงจรสมมูลทวินินของหม้อแปลงพัลส์

โดยที่

$$a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad ; \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

จะได้

$$\frac{V_o(t)}{n} = a V_p e^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad \tau = \frac{L_p}{R}$$

$$V_o(t) = na V_p e^{-\frac{Rt}{L_p}} \quad \dots\dots(3.4)$$

จากรูปที่ 3.3 ที่เวลา  $t = 0$  ,  $V_o = naV_p$

จะได้ความเอียง(droop) ที่เวลา  $t$  ใดๆ เท่ากับ  $D = V_o(t=0) - V_o(t)$

$$D = na V_p \left( 1 - e^{-\frac{Rt}{L_p}} \right) \quad \dots\dots(3.5)$$

ถ้า  $t_d$  คือ ความกว้างของพัลส์(ประมาณ 500 นาโนวินาที)

ที่  $t = t_d$  จะได้สมการ

$$\frac{L_p}{R} = \frac{t_d}{\ln \left[ 1 / \left( 1 - \frac{D}{na V_p} \right) \right]} \quad \dots\dots(3.6)$$

ถ้า  $t \ll L_p/R$  แล้วจะได้  $Rt/L_p \ll 1$

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ในการเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 คำนึงจากสมการที่(3.5) จะได้  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปะสิ่งเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$1 - e^{-\frac{Rt}{L_p}} = \frac{e^{Rt/L_p} - 1}{e^{Rt/L_p}} \approx \frac{Rt}{L_p} \quad ; \quad \left( e^{Rt/L_p} \approx \frac{1 + \frac{Rt}{L_p}}{1 - \frac{Rt}{L_p}} \right)$$

$$D \approx na V_p \frac{Rt_d}{L_p}$$

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ  $naV_p$

$$\%D = \frac{Rt_d}{L_p} \times 100$$

หรือ

$$L_p = \frac{Rt_d}{\%D} \times 100$$

.....(3.7)

### 3.4 การคำนวณหาพารามิเตอร์ของหม้อแปลงพัลส์

ต้องการออกแบบหม้อแปลงพัลส์ที่ความถี่  $f = 1 \text{ kHz}$  กระแสขั้วขาเกิดสูงสุดเท่ากับ 2 แอมป์ ความกว้างพัลส์  $t_d = 500$  นาโนวินาที

คิวตี้ไซเคิล  $k = t_d \cdot f = 500 \times 10^{-9} \times 1000 = 0.0005$

แรงดันเอาต์พุตสูงสุด  $V_o = 15$  โวลต์

อัตราส่วนรอบ  $n = N_s : N_p = 3 : 1$  ดังนั้นแรงดันอินพุต = 5 โวลต์

ใช้แกนทอรอยด์เบอร์ 6x3x2 ใช้สาร 2E1 มี  $\mu_r = 7000$ ,  $B_{max} = 0.4 \text{ T}$ ,

$A_c = 2.81 \text{ mm}^2$ ,  $l_c = 13.1 \text{ mm}$

จากสมการที่(3.2)

$$A_L = \frac{(7000)(4\pi \times 10^{-7})(2.81 \times 10^{-6})}{(13.1 \times 10^{-3})} = 1.881 \times 10^{-6} \text{ เฮนรี่ / รอบ}^2$$

ใช้  $N_p = 10$  รอบ

จากสมการที่3.3

$$L_p = N_p^2 A_L = (10^2)(1.887 \times 10^{-6})$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากสมการที่(3.7)

$$\%D = \frac{R t_d}{L_p} \times 100$$

กำหนด  $R \approx 30$  โอห์ม

$$\%D = \frac{(30)(500 \times 10^{-9})}{(188.7 \times 10^{-6})} \times 100 = 8\%$$

หาการอิมิตัวของแกนทอรอยด์

ออกแบบให้หม้อแปลงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 75%

$$\therefore P_o = 0.75P_{in}$$

$$P_o = 0.75V_{in} I_{in}$$

เมื่อ  $V_{in}$  = ค่าเฉลี่ยของแรงดันอินพุต

$I_{in}$  = ค่าเฉลี่ยของกระแสอินพุตขณะที่  $V = V_{in}$

จาก

$$V_{in} = \frac{N_p \Delta B A_e}{t_d}$$

$$P_o = 0.75 \frac{N_p \Delta B A_e}{t_d} \cdot I_{in}$$

.....(3.8)

จากวงจรทางด้านเอาต์พุต จะได้พลังงานที่หม้อแปลงพลัสจ่ายให้วงจรเอาต์พุต มีค่าประมาณ 4 เท่า ของพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุแฝง ให้  $C_{gs}$  ประมาณ 1 นาโนฟารัด

$$\begin{aligned} P_o &= (4) \frac{1}{2} C_{gs} V_o^2 f \\ &= (2)(10^{-9})(15^2)(10^3) = 4.5 \times 10^{-4} \text{ W} \end{aligned}$$

$$I_{in} = n I_{max} = (3)(2) = 6A$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากสมการที่(3.8)

$$\begin{aligned}\Delta B &= \frac{P_o t_d}{(0.75)N_p A_e I_{in}} \\ &= \frac{(4.5 \times 10^{-4})(500 \times 10^{-9})}{(0.75)(10)(2.81 \times 10^{-6})(6)} = 1.8 \mu T\end{aligned}$$

แต่ แกนทอรอยด์ที่ใช้มี  $\Delta B_{max} = 0.4T$

เนื่องจากว่า  $\Delta B < \Delta B_{max}$  ทำให้แกนทอรอยด์ที่ใช้ไม่อึดตัว เมื่อนำมาใช้เป็นหม้อแปลงพัลส์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### หม้อแปลงกระแส

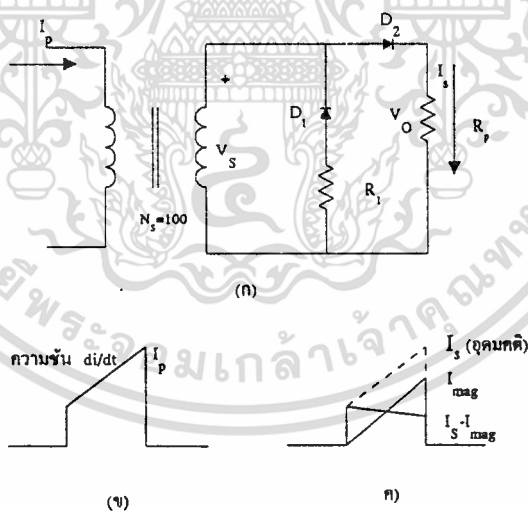
#### 4.1 หน้าที่ของหม้อแปลงกระแสในวงจร

- ทำหน้าที่วัดค่ากระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์กำลัง เพื่อนำสัญญาณที่ได้ไปใช้ในระบบป้องกันการลัดวงจรเพื่อจำกัดกระแสเมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้น
- แยกระหว่างวงจรด้านที่วัดกระแสและวงจรควบคุมการลัดวงจรได้อย่างอิสระ

#### 4.2 การออกแบบหม้อแปลงกระแส

##### 4.2.1 ขนาดของแกนหม้อแปลงและกระแสแมกนีโตซิ่ง

การเลือกขนาดของแกนที่ใช้พันหม้อแปลงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการออกแบบหม้อแปลงกระแส เนื่องจากจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมระหว่างสมรรถนะของหม้อแปลงในอุดมคติและสมรรถนะในทางปฏิบัติอันได้แก่ ขนาด ราคา และจำนวนรอบที่ใช้



รูปที่ 4.1 (ก) หม้อแปลงกระแสและวงจรทุติยภูมิ

(ข) รูปกราฟของกระแสด้านปฐมภูมิ

(ค) รูปกราฟของกระแสที่เกิดขึ้นบน  $R_p$  แสดงถึงผลของกระแส

แมกนีโตซิ่งของหม้อแปลง

จากรูปจะเห็นได้ว่ากระแสแมกนีโตซิ่งที่เกิดขึ้น จะมีผลทำให้รูปร่างของกระแสทางด้านทุติยภูมิเปลี่ยนแปลงไปจากพัลส์กระแสทางด้านปฐมภูมิ โดยทำให้พัลส์กระแส ( $I_s$ ) ลดลงเมื่อเวลาเอกสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผ่านไป ซึ่งถ้าหากว่านำเอาค่าสูงสุดของ  $I_p$  มาใช้งานแล้วจะทำให้สัญญาณที่ได้มีความผิดพลาดมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบให้มีกระแสแมกนีไทซ์มีค่าน้อยๆ

กระแสแมกนีไทซ์จะมีค่าแปรผกผันกับค่าความเหนี่ยวนำของหม้อแปลงกระแสจึงสามารถลดกระแสแมกนีไทซ์ได้โดยการออกแบบให้หม้อแปลงมีค่าความเหนี่ยวนำสูงๆ โดยพิจารณาจากสมการ

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N_c^2 A_c}{l_c} \quad \text{.....(4.1)}$$

เมื่อ  $\mu_0$  คือ ค่าความซึมซาบของอากาศมีค่าเท่ากับ  $4\pi \times 10^{-7}$  (เฮนรี/เมตร)

$\mu_r$  คือ ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (จำนวนเท่าของ  $\mu_0$ )

$N_c$  คือ จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ (รอบ)

$A_c$  คือ พื้นที่หน้าตัดของแกนทอรอยด์ ( $\text{ม}^2$ .)

$l_c$  คือ ความยาวของทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กบนแกนทอรอยด์ (มม.)

เมื่อต้องการเพิ่มค่าความเหนี่ยวนำจึงต้องเลือกวัสดุที่ใช้ทำแกนมีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์,  $\mu_r$  สูงๆ และใช้จำนวนรอบทางด้านทุติยภูมิมากๆ

ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อกระแสแมกนีไทซ์อีกอย่างหนึ่งคือ ขนาดของแรงดันด้านทุติยภูมิ ซึ่งจากวงจรรูปที่ 4.1(ก) จะมีค่าเท่ากับแรงดันของสัญญาณ  $V_o$  และแรงดันตกคร่อมไดโอด  $D_2$  ขณะนำกระแส (ประมาณ 0.6 V) ค่าแรงดันทุติยภูมินี้ควรให้มีค่าน้อยที่สุด เนื่องจากถ้าแรงดันมากจะทำให้กระแสแมกนีไทซ์มีค่าสูงตามไปด้วย

เมื่อเลือกใช้แกนทอรอยด์ที่มีขนาดเล็กมากๆ จากสมการที่ 4.1 เพื่อให้ได้ค่าความเหนี่ยวนำสูงๆ จึงต้องพันขดลวดให้ได้จำนวนรอบมากๆ แต่ถ้ามีค่าสูงเกินไป (เกิน 200 รอบขึ้นไป) ตัวเก็บประจุระหว่างขดลวดจะมีผลต่อวงจรและได้ผลตอบสนองที่ความถี่สูงๆ (พัลส์กระแสแคบๆ) เลวลง ดังนั้นการเลือกแกน ควรจะให้เหมาะสมทั้งราคาและสมรรถนะที่ได้ สำหรับจำนวนรอบที่เหมาะสมควรใช้ประมาณ 100 รอบ ขึ้นไป โดยพันบนแกนทอรอยด์ให้ได้ภายในชั้นเดียว

#### 4.2.2 ขั้นตอนในการออกแบบหม้อแปลงกระแส

ต้องการออกแบบหม้อแปลงกระแสตามรูปที่ 4.1 ก โดยต้องการจำกัดกระแสทางด้านปฐม

ภูมิที่  $I_p=30$  แอมป์  
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดค่า แอมแปร์-รอบ ของกระแสต้านปฐมภูมิ

เนื่องจากต้องการจำกัดกระแสที่ 30 แอมป์ โดยที่ใช้จำนวนรอบของปฐมภูมิ 1 รอบ (คล้อยผ่านแกนทอโรอยด์) ดังนั้นจะได้ค่า แอมแปร์-รอบเป็น 30 แอมแปร์-รอบ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจำนวนรอบและกระแสของขดลวดทุติยภูมิ

ใช้จำนวนรอบทุติยภูมิ  $N_s=100$  รอบ

ดังนั้นจะได้กระแสทางด้านทุติยภูมิ  $I_s = 30/100 = 0.3$  A

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดแรงดันด้านทุติยภูมิ

เนื่องจากแรงดัน  $V_o$  ที่ได้จะนำไปขับทรานซิสเตอร์เพื่อคายประจุของตัวเก็บประจุแผ่น  $C_s$  ดังนั้น เลือก

$$V_s = V_D + V_o = 0.6 + 0.6 = 1.2 \text{ V}$$

$$\therefore \text{จะได้ } R_p = V_o / I_s = 1.2 / 0.3 = 4 \Omega$$

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบกระแสแมกนีไทซ์

ใช้แกนทอโรอยด์ เบอร์ 6 x 3 x 2 มี  $A_c = 2.81 \text{ mm}^2$ ,  $l_c = 13.1 \text{ mm}$

ทำจากสาร 2E1 มี ค่าความซึมซาบแม่เหล็ก  $\mu_r = 7000$  เท่า และ  $B_{\max} = 0.4 \text{ T}$

คำนวณค่าความเหนี่ยวนำได้จากสมการที่ 4.1

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N_s^2 A_c}{l_c}$$

$$L = \frac{(7000)(4\pi \times 10^{-7})(100^2)(2.81 \times 10^{-6})}{13.1 \times 10^{-3}}$$

$$L = 18.87 \text{ mH}$$

$\therefore$  คำนวณค่าความชัน  $dI/dt$  ของกระแสแมกนีไทซ์ ได้จาก

$$e = -L \frac{dI}{dt}$$

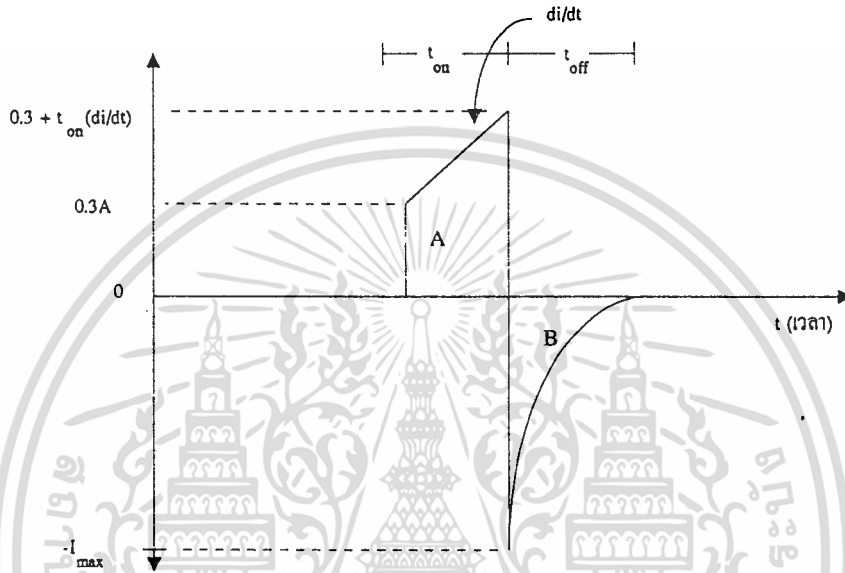
$$\left| \frac{dI}{dt} \right| = \frac{e}{L}$$

$$\text{เมื่อ } e = V_s = 1.2 \text{ V}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อ  $\left| \frac{dI}{dt} \right| = \frac{1.2}{18.87 \times 10^{-3}} = 63.6 \text{ A/S}$  ศึกษาเท่านั้น ไม่ควรเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธี  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หา  $R_1$ ,

จากวงจรรูปที่ 4.1 ไดโอด  $D_1$  มีไว้เพื่อให้กระแสद्यุขุมิไหลผ่านหม้อแปลงได้สองทิศทาง ทำให้กระแสเฉลี่ยของหม้อแปลงเท่ากับศูนย์ หม้อแปลงจะไม่อิ่มตัว



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงกระแสद्यุขุมิของหม้อแปลงกระแส

ในการทำงานของระบบ ป้องกันการลัดวงจรนั้น จะออกแบบให้ตัวเก็บประจุแผ่กระจายประจุภายในเวลา 500 นาโนวินาทีและเนื่องจากในช่วงที่มีสัญญาณพัลส์บวกช่วงสั้นๆ(ประมาณนาโนวินาที) ผ่านเข้ามาที่หม้อแปลงพัลส์นั้นระบบป้องกันการลัดวงจรจะไม่ทำงาน ดังนั้นต้องกำหนดความกว้างของพัลส์กระแสเพื่อในช่วงเวลานี้ด้วย

$$\therefore t_{on} = 500 + 500 = 1000 \text{ นาโนวินาที}$$

ส่วน  $t_{off}$  นั้น เป็นเวลาน้อยที่สุดที่จะมีได้ในลำดับการทำงานของอุปกรณ์กำลังซึ่งจะขึ้นอยู่กับความถี่ที่ใช้ ( $t_{off}$  ยิ่งน้อยความถี่ที่ใช้งานได้จะยิ่งสูง)

ดังนั้น เลือก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน  $t_{off} = 500$  นาโนวินาที เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 4.2 ต้องการให้กระแสเฉลี่ยคร่อมหม้อแปลงเท่ากับศูนย์

$$\therefore \text{พ.ทได้กราฟ A} = \text{พ.ทได้กราฟ B} \quad \dots\dots(4.2)$$

โดยประมาณให้พื้นที่ใต้กราฟ B เป็นรูปสามเหลี่ยม ,จะได้สมการที่ (4.2) เป็น

$$\frac{1}{2} \left[ 0.3 + \left( 0.3 + \frac{dI}{dt} \times t_{\text{on}} \right) \right] t_{\text{on}} = \frac{1}{2} (t_{\text{off}}) I_{\text{max}}$$

$$\frac{1}{2} (0.3 + 0.3 + 63.6 \times 1000 \times 10^{-9}) \times 1000 \times 10^{-9} = \frac{1}{2} (500 \times 10^{-9}) I_{\text{max}}$$

$$\therefore I_{\text{max}} = 1.2 \text{ แอมแปร์}$$

$$\text{จะได้ } R_1 = -V_S / I_{\text{max}} = 1.2 / 1.2 = 1 \Omega$$

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบการอิ่มตัวของแกนทอรอยด์

ขณะที่หม้อแปลงทำงานกำเนิดพัลส์กระแสขึ้นมานั้น จะต้องไม่ให้หม้อแปลงอิ่มตัวเพื่อให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงานไม่ผิดพลาด

$$\text{จาก } B = \frac{V t_{\text{on}}}{N_s A_c}$$

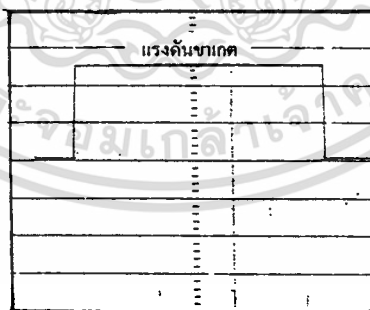
$$B = \frac{1.2 \times 1000 \times 10^{-9}}{100 \times 2.81 \times 10^{-6}} = 4.26 \text{ mT}$$

ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า B ที่ได้นั้นมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ  $B_{\text{max}}$  ของแกนทอรอยด์ ( $B_{\text{max}} = 0.4 \text{ T}$ ) ดังนั้นแกนทอรอยด์จะไม่อิ่มตัวตลอดช่วงการทำงานของหม้อแปลงกระแส

## บทที่ 5

### ผลการทดลอง

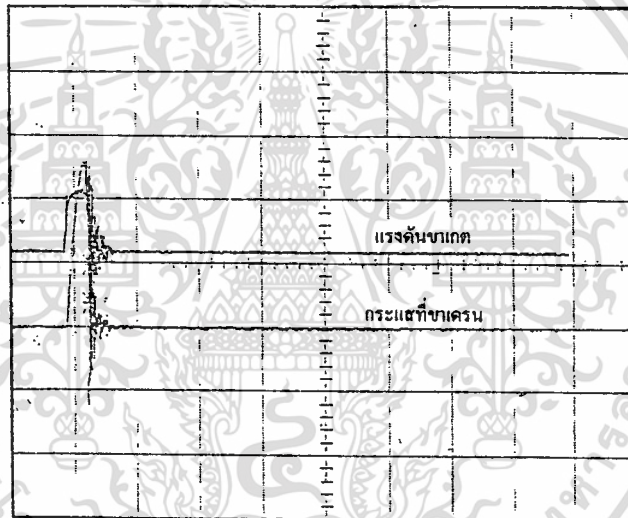
วงจรที่ใช้งานจริงสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.3 ซึ่งได้ทำการทดลองนำไปจับเกิดของมอสเฟตกำลังเบอร์ PM4550 2C HITACHI วงจรทางด้านอินพุตของหม้อแปลงพัลส์จะกำเนิดพัลส์ควบคุมขนาดความกว้าง 500 นาโนวินาที สามารถควบคุมมอสเฟตกำลังเทอร์นอนและเทอร์นอนออฟได้ที่มีความถี่ 1 kHz ดังจะเห็นได้จากกราฟแรงดันที่ขาเกิดของ PM4550 2C ในรูปที่ 5.1 ซึ่งจะมีจังหวะการทำงานเป็นไปตามสัญญาณควบคุม



รูปที่ 5.1 สัญญาณพัลส์ที่หม้อแปลงพัลส์และสัญญาณที่ขาเกิด-ซอร์ส

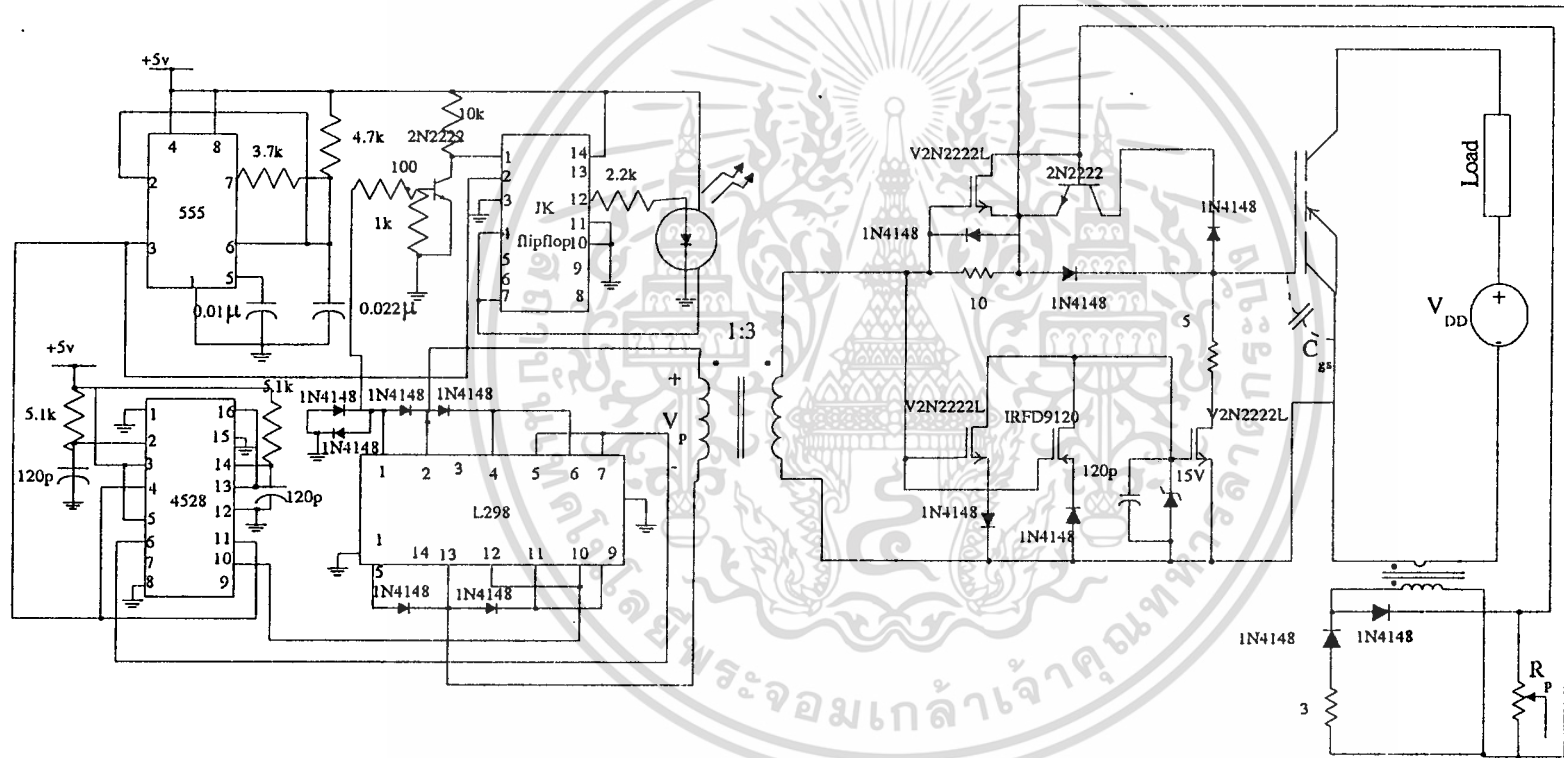
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทำงานของระบบป้องกันการลัดวงจรแสดงได้ดังรูปที่ 5.2 จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรซึ่งจำกัดไว้ที่ 30 แอมป์ ระบบป้องกันจะทำงานหลังจากที่มอสเฟตกำลังเกิดการเทิร์นออนหน่วงไปประมาณ 500 นาโนวินาทีซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นการป้องกันการไม่นำกระแสของมอสเฟตกำลังจากการเกิดกระแสไดโอดรีคอฟเวอร์ หลังจากนั้นระบบป้องกันจะเริ่มทำงานคายประจุจากตัวเก็บประจุแฝงมอสเฟตกำลังจึงหยุดนำกระแส ทำให้กระแสที่ขาเดรนลดลงจนเป็นศูนย์



รูปที่ 5.2 พฤติกรรมการลัดวงจรของมอสเฟตกำลังเบอร์ PM4550 2C HITACHI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.8 วงจรที่ใช้งานจริง

## บทที่ 6

### สรุปและวิจารณ์

วงจรขั้วขาเกิดแบบแยกอิสระที่ทำขึ้นนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำงานร่วมกับมอสเฟตและไอจีบีที โดยจะมี การแยกอิสระระหว่างวงจรควบคุมด้านอินพุตและวงจรควบคุมด้านเอาต์พุต โดยใช้หม้อแปลงพัลส์ ซึ่งมีข้อดีคือ ทำให้วงจรมีราคาถูกเนื่องจากไม่สิ้นเปลืองแหล่งจ่ายไฟเมื่อนำมาใช้ขั้วมอสเฟตกำลังหรือไอจีบีทีหลายตัว พลังงานที่จ่ายให้กับวงจรขั้วมีค่าเพียงเล็กน้อยประมาณ 4 เท่าของพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุแฝง จึงสามารถใช้หม้อแปลงพัลส์ที่มีขนาดเล็กได้ การกำหนดความถี่การทำงานสามารถทำได้โดย เปลี่ยนความถี่ของไทเมอร์555 ซึ่งเป็นตัวกำเนิดพัลส์ที่ใช้ควบคุมลำดับการทำงานของอุปกรณ์กำลัง พัลส์ที่ใช้ควบคุมมีขนาดความกว้างของพัลส์แคบมาก(500นาโนวินาที) ทั้งพัลส์บวกที่ใช้ควบคุมให้อุปกรณ์กำลังนำกระแส และพัลส์ลบที่ใช้ควบคุมให้อุปกรณ์กำลังหยุดนำกระแส จึงสามารถประยุกต์ใช้กับความถี่หลายร้อยกิโลเฮิร์ตได้

วงจรทางด้านเอาต์พุตได้ถูกออกแบบให้สามารถจำลองสถานะการนำกระแส และหยุดนำกระแสของอุปกรณ์กำลังได้ โดยถ้ามีสัญญาณควบคุมให้อุปกรณ์กำลังนำกระแส(พัลส์บวก) เมื่ออุปกรณ์กำลังนำกระแสแล้ว จะมีแรงดันตกคร่อมขาเกิดและชาซอร์สเป็นค่าบวกคงที่ตลอดเวลา จึงสามารถที่จะทำให้เกิดการนำกระแสได้ตลอดช่วงจนกว่าจะมีสัญญาณควบคุม(พัลส์ลบ)ให้หยุดนำกระแส การหยุดนำกระแสจะมีตัวเก็บประจุช่วยในการจำลองสถานะ โดยที่จะทำให้ค่าอิมพีแดนซ์ที่ขาเกิดและชาซอร์สของอุปกรณ์กำลังมีค่าต่ำตลอดช่วงการหยุดนำกระแส ทำให้อุปกรณ์กำลังนำกระแสเองไม่ได้ นอกจากจะมีสัญญาณพัลส์บวกเข้ามาที่หม้อแปลงพัลส์

ในการนำมอสเฟตกำลังหรือไอจีบีทีไปใช้เป็นสวิตช์กำลัง เมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นที่โหลด จะทำให้เกิดกระแสจำนวนมากไหลผ่านตัวสวิตช์ ซึ่งทำให้อุปกรณ์กำลังเสียหายได้ จึงต้องออกแบบให้วงจรทางด้านเอาต์พุตมีระบบป้องกันการลัดวงจร โคนใช้หม้อแปลงกระแสตรวจจับกระแสที่ไหลผ่านตัวอุปกรณ์กำลัง เมื่อเกิดกระแสเกินขีดจำกัดความสามารถ ระบบป้องกันจะทำงานโดยการคายประจุของตัวเก็บประจุแฝงเพื่อให้อุปกรณ์กำลังหยุดนำกระแสได้ทันก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น การคายประจุของตัวเก็บประจุแฝงนั้น จะคายประจุผ่านหม้อแปลงพัลส์เพื่อที่จะส่งพัลส์กระแสไปทางด้านเอาต์พุต เมื่อพัลส์กระแสที่ได้ ไหลผ่านวงจรเตือนซึ่งใช้ฟลิปฟลอปช่วยในการจำลองสถานะ ซึ่งสามารถนำเอาต์พุตของฟลิปฟลอปนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้เช่น อาจจะไปอินเทอร์พรีตไมโคร โปรเซสเซอร์ที่ใช้ควบคุมวงจรบอกให้ผู้รู้ว่า เกิดการลัดวงจรขึ้น นอกจากนั้น การออกแบบระบบป้องกันการลัดวงจรจะเกิดปัญหา เนื่องจากเกิดกระแสไดโอดรีคอฟเวอร์ที่ไหลผ่านตัวอุปกรณ์ขณะตัวอุปกรณ์กำลังจะนำกระแส ซึ่งกระแสนี้มีค่าใกล้เคียงกับกระแสลัดวง

จร ทำให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงาน ทำให้อุปกรณ์กำลังไม่สามารถนำกระแสได้ จึงต้องการ ป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันการลัดวงจรทำงาน ขณะเกิดกระแสไดโอดรีคอปเฟอวรี่ ซึ่งจากวงจรทาง ด้านเอาท์พุทตลอดช่วงที่มีสัญญาณพัลส์บวกเข้ามาที่หม้อแปลงพัลส์ ระบบป้องกันการลัดวงจรจะ ไม่ทำงาน(ในช่วง500นาโนวินาทีของสัญญาณพัลส์บวก) เมื่อพัลส์บวกหายไป ระบบป้องกันการ ลัดวงจรจะสามารถทำงานได้ตามปกติ

หม้อแปลงกระแสที่ใช้ทำให้เกิดการแยกอิสระระหว่างกระแสทางวงจรที่ใช้อุปกรณ์กำลัง เป็นสวิตช์และกระแสที่ใช้ควบคุมวงจรป้องกันการลัดวงจร ทั้งยังมีขนาดเล็ก จ่ายพลังงานขับ ทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กๆเพียงตัวเดียว การออกแบบจะพยายามลดจำนวนอุปกรณ์ลงไปให้น้อยที่ สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งยังราคาถูก อุปกรณ์ที่ใช้สามารถหาได้ง่าย การใช้งานง่าย สามารถ ขับอุปกรณ์กำลังตัวใหญ่ได้โดยใช้วงจรเดิม ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการผลิตวงจรขับเคลื่อนเป็น ไอซีออกมาขายแต่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการแยกอิสระระหว่างวงจรควบคุมกับวงจรทางด้านขาเดรน ไม่ดีนักเนื่องจากเมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลาหลายๆ จะทำให้สารที่ใช้ทำเป็นฉนวนนั้นเสื่อมลงแต่ วงจรที่ใช้ออกแบบนี้ใช้อากาศเป็นตัวแยกอิสระจึงไม่มีการเสื่อมเมื่อใช้งานไปนานๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เอกสารอ้างอิง

- [1] J.M.Bourgeois SGS -Thomson.,Microelectronic, Z.I.Peynier Rousset,1300 Rousset Cedex, France, “A New Isolated Gate Drive for Power MOSFETs and IGBTs” ,EPE FIRENZE,1991,P.1-187-P.1-192.
- [2] M.A.Nadkarni, S.Ramesh Bhat.,“Pulse Transformer Design and Fabrication” , McGraw-Hill,Newdelhi,1985,P.4-P.157.
- [3] Abraham L. Pressman,“Switching Power Supply Design” ,McGraw-Hill International,Edition Engineering series.P.3.177-P.3.192.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้